

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-368190

(43)Date of publication of application : 20.12.2002

(51)Int.Cl.

H01L 25/065

H01L 25/07

H01L 25/18

(21)Application number : 2002-012775

(71)Applicant : HITACHI LTD

HITACHI HOKKAI SEMICONDUCTOR LTD

(22)Date of filing : 22.01.2002

(72)Inventor : NAKAMURA SHIGERU

GOTO MASAKATSU

(30)Priority

Priority number : 2001108603

Priority date : 06.04.2001

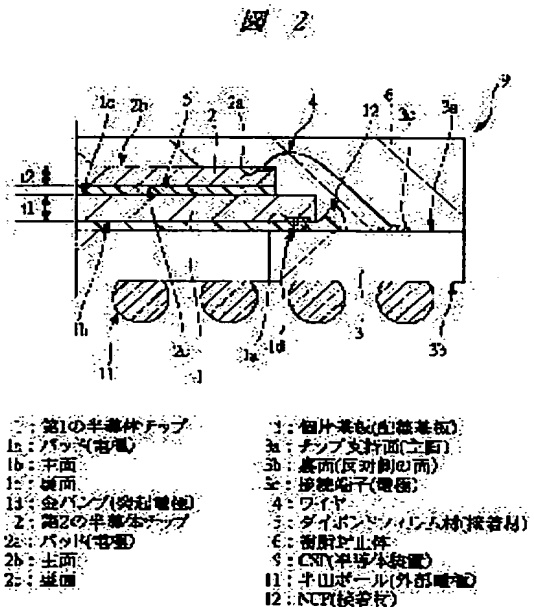
Priority country : JP

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To thin a semiconductor device which has a stacked structure.

SOLUTION: The semiconductor device is provided with a single-board substrate 3 which has a plurality of connection terminals 3c on a chip-supporting surface 3a and a plurality of solder balls 11 on a rear surface 3b, a first semiconductor chip 1 which has a main surface 1b and a rear surface 1c and has a plurality of pads 1a and a plurality of semiconductor elements on the surface 1b, a second semiconductor chip 2 which is smaller in thickness than that of the semiconductor chip 1, has a main surface 2b and a rear surface 2c and a rear surface 2c and has a plurality of pads 2a and a plurality of semiconductor elements on the surface 2b, a resin-sealing body which is formed on the surface 3a of the substrate 3 and seals the chips 1 and 2, and a wire 4, which connects the pads 2a of the chip 2 to the terminals 3c of the substrate 3 according to the pads 2a. In this device, the chip 1 is made thinner than the chip 2, thereby thinning the stacked structure.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-368190
(P2002-368190A)

(43) 公開日 平成14年12月20日 (2002. 12. 20)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード (参考)

H 0 1 L 25/065
25/07
25/18

H 0 1 L 25/08

Z

審査請求 未請求 請求項の数43 O L (全 36 頁)

(21) 出願番号 特願2002-12775 (P2002-12775)
(22) 出願日 平成14年1月22日 (2002. 1. 22)
(31) 優先権主張番号 特願2001-108603 (P2001-108603)
(32) 優先日 平成13年4月6日 (2001. 4. 6)
(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000005108
株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
(71) 出願人 000233594
日立北海セミコンダクタ株式会社
北海道亀田郡七飯町字中島145番地
(72) 発明者 中村 滋
北海道亀田郡七飯町字中島145番地 日立
北海セミコンダクタ株式会社内
(74) 代理人 100080001
弁理士 筒井 大和

最終頁に続く

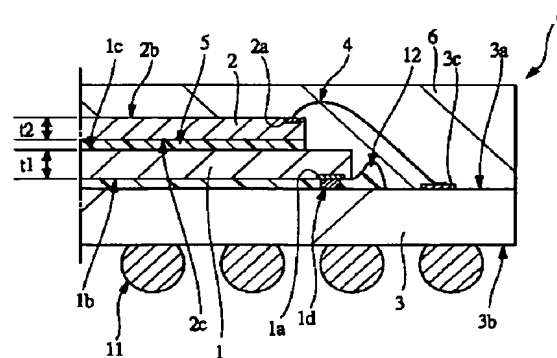
(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 スタック構造の半導体装置の薄形化を図る。

【解決手段】 チップ支持面3a上に複数の接続端子3cを有し、かつ裏面3b上に複数の半田ボール11を有する個片基板3と、主面1bおよび裏面1cを有し、かつ主面1b上に複数のパッド1aと複数の半導体素子とを有する第1の半導体チップ1と、主面2bおよび裏面2cを有し、かつ主面2b上に複数のパッド2aと複数の半導体素子とを有するとともに、第1の半導体チップ1より厚さの薄い第2の半導体チップ2と、個片基板3のチップ支持面3a上に形成され、かつ第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2を封止する樹脂封止体6と、第2の半導体チップ2のパッド2aとこれに対応する個片基板3の接続端子3cとを接続するワイヤ4とからなり、第1の半導体チップ1より第2の半導体チップ2を薄くしてスタック構造の薄形化を図る。

図 2



- | | |
|----------------|--------------------|
| 1: 第1の半導体チップ | 3: 個片基板(配線基板) |
| 1a: パッド(電極) | 3a: チップ支持面(主面) |
| 1b: 主面 | 3b: 裏面(反対側の面) |
| 1c: 裏面 | 3c: 接続端子(電極) |
| 1d: 金バンプ(突起電極) | 4: ワイヤ |
| 2: 第2の半導体チップ | 5: ダイボンドフィルム材(接着材) |
| 2a: パッド(電極) | 6: 樹脂封止体 |
| 2b: 主面 | 9: CSP(半導体装置) |
| 2c: 裏面 | 11: 半田ボール(外部電極) |
| | 12: NCR(接着材) |

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 主面および裏面を有しており、前記主面上に複数の電極を有するとともに、前記裏面上に複数の外部電極を有する配線基板と、

主面および裏面を有しており、前記主面上に複数の電極と複数の半導体素子とを有する第 1 の半導体チップと、主面および裏面を有しており、前記主面上に複数の電極と複数の半導体素子とを有するとともに、前記第 1 の半導体チップより薄い第 2 の半導体チップと、

前記配線基板の主面上に形成されており、前記第 1 および第 2 の半導体チップを封止する樹脂封止体とを有する半導体装置であって、

前記第 1 の半導体チップは、前記配線基板の主面上に前記第 1 の半導体チップの複数の電極が前記配線基板の複数の電極と対向するように、前記第 1 の半導体チップの主面と前記配線基板の主面とが向かい合って配置されており、

前記第 2 の半導体チップは、前記配線基板の主面上に前記第 1 の半導体チップを介して配置されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の半導体装置であって、前記第 1 および第 2 の半導体チップは、接着材を介してお互いの裏面が向かい合って前記配線基板の主面上に配置されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 3】 請求項 2 記載の半導体装置であって、前記第 2 の半導体チップの複数の電極と、前記配線基板の複数の電極とのそれぞれを電気的に接続する複数のワイヤを有することを特徴とする半導体装置。

【請求項 4】 請求項 3 記載の半導体装置であって、前記第 1 の半導体チップの複数の電極は、前記配線基板の複数の電極と圧接していることを特徴とする半導体装置。

【請求項 5】 請求項 4 記載の半導体装置であって、前記第 1 の半導体チップの主面と、前記配線基板の主面との間は接着材を介して固定されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項 6】 請求項 1 記載の半導体装置であって、前記第 1 の半導体チップのバス周波数は、前記第 2 の半導体チップのバス周波数よりも大きいことを特徴とする半導体装置。

【請求項 7】 請求項 6 記載の半導体装置であって、前記第 1 の半導体チップはロジックチップであり、前記第 2 の半導体チップはメモリチップであることを特徴とする半導体装置。

【請求項 8】 (a) 主面上に複数の電極を有する配線基板を準備する工程と、

(b) 主面および裏面を有しており、前記主面上に複数の電極と複数の半導体素子とを有する第 1 の半導体チップを準備する工程と、

(c) 主面および裏面を有しており、前記主面上に複数

の電極と複数の半導体素子とを有するとともに、前記第 1 の半導体チップより薄い第 2 の半導体チップを準備する工程と、

(d) 前記第 1 の半導体チップの主面を前記配線基板の主面に向かい合わせて、かつ前記第 1 の半導体チップの複数の電極が前記配線基板の複数の電極と対向するように、前記第 1 の半導体チップを前記配線基板の主面上に配置する工程と、

(e) 前記 (d) 工程後に前記第 1 の半導体チップの裏面に圧力を加え、前記第 1 の半導体チップの複数の電極と前記配線基板の複数の電極とを電気的に接続する工程と、

(f) 前記 (e) 工程後に、前記第 1 の半導体チップの裏面上に前記第 2 の半導体チップを、前記第 1 の半導体チップの裏面と前記第 2 の半導体チップの裏面とが接着材を介して向かい合う様に前記 (e) 工程時に加えた圧力より小さな圧力を加えて配置する工程と、

(g) 前記第 2 の半導体チップの複数の電極と前記配線基板の複数の電極とを複数のワイヤを介して電気的に接続する工程と、

(h) 前記第 1、第 2 の半導体チップおよび前記複数のワイヤを封止する樹脂封止体を形成する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 9】 請求項 8 記載の半導体装置の製造方法であって、前記 (e) 工程時に、前記第 1 の半導体チップに圧力と同時に熱を加えることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 10】 請求項 9 記載の半導体装置の製造方法であって、前記 (e) 工程時に加えた熱によって、前記第 1 の半導体チップの主面と前記配線基板の主面との間で熱硬化性樹脂を硬化させ、前記熱硬化性樹脂を介して前記第 1 の半導体チップを前記配線基板の主面上に固定することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 11】 請求項 8 記載の半導体装置の製造方法であって、前記 (e) 工程時に、前記第 1 の半導体チップに圧力と同時に超音波を加えることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 12】 請求項 11 記載の半導体装置の製造方法であって、前記第 1 の半導体チップの電極に突起電極として金バンプが形成され、前記 (e) 工程時に、前記第 1 の半導体チップに圧力と同時に超音波を加えて、超音波金-金接続によって前記第 1 の半導体チップと前記配線基板とを接続することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 13】 請求項 8 記載の半導体装置の製造方法であって、前記第 1 の半導体チップの複数の電極のそれぞれは、前記第 1 の半導体チップの主面上に形成されたパッドと、前記パッド上に配置された突起電極とによって構成されることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 14】 請求項 8 記載の半導体装置の製造方法

であって、前記(h)工程後に、前記配線基板の主面と反対側の裏面上に、前記配線基板の複数の電極と電氣的に接続する複数の外部電極である突起電極を形成する工程をさらに有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項15】 請求項8記載の半導体装置の製造方法であって、前記(e)工程と(f)工程の間にさらに、

(i) 主面および裏面を有しており、前記主面上に複数の電極と複数の半導体素子を有する第3の半導体チップを準備する工程と、

(j) 前記第3の半導体チップの主面を前記配線基板の主面に向かい合わせて、かつ前記第3の半導体チップの複数の電極が前記配線基板の複数の電極と対向するように、前記第3の半導体チップを前記配線基板の主面上に配置する工程と、

(k) 前記(j)工程後に前記第3の半導体チップの裏面に圧力を加え、前記第3の半導体チップの複数の電極と前記配線基板の複数の電極とを電氣的に接続する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項16】 請求項15記載の半導体装置の製造方法であって、前記(k)工程後にさらに、

(l) 主面および裏面を有しており、前記主面上に形成された複数の電極と複数の半導体素子とを有するとともに、前記第3の半導体チップより薄い第4の半導体チップを準備する工程と、

(m) 前記第3の半導体チップの裏面上に前記第4の半導体チップを、前記第3の半導体チップの裏面と前記第4の半導体チップの裏面とが接着材を介して向かい合う様に前記(k)工程時に加えた圧力よりも小さな圧力を加えて配置する工程と、

(n) 前記第4の半導体チップの複数の電極と前記配線基板の複数の電極とを複数のワイヤを介して電氣的に接続する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項17】 (a) 互いに向かい合う第1および第2の側面と、前記第1および第2の側面と接しており、互いに向かい合う第3および第4の側面を有するキャビティ、および前記第1の側面上に形成された樹脂注入口を持つ金型を準備する工程と、

(b) 主面を有する配線基板、前記配線基板の主面上に固定された第1の半導体チップ、前記第1の半導体チップの上に固定された第2の半導体チップを準備する工程と、

(c) 前記配線基板、前記第1および第2の半導体チップを前記キャビティの内部に配置する工程と、(d) 前記(c)工程後、前記樹脂注入口より樹脂を注入して、前記第1およ

び第2の半導体チップを封止する工程とを有する半導体装置の製造方法であって、

前記(c)工程において、前記キャビティの第3の側面

と平行な断面において、前記第1の半導体チップの長さは、前記第2の半導体チップの長さよりも長くなるように、前記配線基板、第1および第2の半導体チップを配置することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項18】 請求項17記載の半導体装置の製造方法であって、前記(c)工程において、前記キャビティの第1の側面と平行な断面において、前記第1の半導体チップの長さは、前記第2の半導体チップの長さよりも短くなるように、前記配線基板、前記第1および第2の半導体チップを配置することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項19】 請求項17記載の半導体装置の製造方法であって、前記金型は、前記第2の側面上に形成された空気孔を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項20】 (a) 互いに向かい合う第1および第2の側面と、前記第1および第2の側面と接しており、互いに向かい合う第3および第4の側面を有するキャビティ、および前記第1の側面上に形成された複数の樹脂注入口を持つ金型を準備する工程と、

(b) 主面を有するとともに複数のデバイス領域が形成された配線基板、前記配線基板の複数のデバイス領域のそれぞれに固定された第1の半導体チップ、前記第1の半導体チップ上に固定された第2の半導体チップを準備する工程と、

(c) 前記配線基板、前記複数の第1および第2の半導体チップを前記キャビティの内部に配置して前記複数のデバイス領域を前記キャビティによって一括で覆う工程と、

(d) 前記(c)工程後、それぞれのデバイス領域に対応した複数の樹脂注入口より樹脂を注入して、前記複数の第1および第2の半導体チップを一括で封止する工程とを有する半導体装置の製造方法であって、前記(c)工程において、前記キャビティの第3の側面と平行な断面において、それぞれの前記第1の半導体チップの長さは、前記第1の半導体チップに積層された前記第2の半導体チップの長さよりも長くなるように、前記配線基板、前記複数の第1および第2の半導体チップを配置することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項21】 (a) 互いに向かい合う第1および第2の側面と、前記第1および第2の側面と接しており、互いに向かい合う第3および第4の側面を有するキャビティ、および前記第1の側面上に形成された樹脂注入口を持つ金型を準備する工程と、

(b) 主面を有する配線基板、前記配線基板の主面上に接着材を介して固定された第1の半導体チップ、前記第1の半導体チップの上に固定された第2の半導体チップを準備する工程と、

(c) 前記配線基板、前記第1および第2の半導体チップを前記キャビティの内部に配置する工程と、

10

20

30

40

50

(d) 前記(c)工程後、前記樹脂注入口より樹脂を注入して、前記第1および第2の半導体チップを封止する工程とを有する半導体装置の製造方法であって、前記(b)工程において、前記第2の半導体チップは、前記第1の半導体チップの外周より平面的に突出する部分を有しており、前記第2の半導体チップの突出する部分と前記配線基板の主面との間は、前記接着材によって充填されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項22】 請求項21記載の半導体装置の製造方法であって、前記(d)工程において、前記樹脂を注入する際、前記樹脂が硬化する前に樹脂に圧力を加えることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項23】 (a) 互いに向かい合う第1および第2の側面と、前記第1および第2の側面と接しており、互いに向かい合う第3および第4の側面を有するキャビティ、および前記第1の側面上に形成された樹脂注入口を持つ金型を準備する工程と、

(b) 主面を有する配線基板、前記配線基板の主面上に接着材を介して固定された第1の半導体チップ、前記第1の半導体チップの上に固定された第2の半導体チップを準備する工程と、

(c) 前記配線基板、前記第1および第2の半導体チップを前記キャビティの内部に配置する工程と、

(d) 前記(c)工程後、前記樹脂注入口より樹脂を注入して、前記第1および第2の半導体チップを封止する工程とを有する半導体装置の製造方法であって、前記(b)工程において、前記第2の半導体チップは、前記第1の半導体チップの外周より、前記キャビティの第2の側面に向かって突出する部分を有しており、前記第2の半導体チップの突出する部分と前記配線基板の主面との間は、前記接着材によって充填されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項24】 請求項23記載の半導体装置の製造方法であって、前記(d)工程において、前記樹脂を注入する際、前記樹脂が硬化する前に樹脂に圧力を加えることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項25】 (a) 主面および前記主面上に形成された第1および第2の複数の電極を有する配線基板を準備する工程と、

(b) 主面および前記主面上に形成された複数の突起電極、複数の半導体素子をそれぞれ有する複数の半導体チップよりなる第1の半導体チップ群および第2の半導体チップ群を準備する工程と、

(c) 前記配線基板の第1の複数の電極上に第1の接着材を配置する工程と、

(d) 前記(c)工程後に、前記第1の半導体チップ群を構成する複数の半導体チップを熱圧着し、前記第1の接着材を介して前記配線基板の主面上に固定するとともに、前記第1の半導体チップ群を構成する複数の半導体

チップそれぞれの複数の突起電極と、前記配線基板の第1の複数の電極とを電気的に接続する工程と、

(e) 前記(d)工程後に、前記配線基板の第2の複数の電極上に第2の接着材を配置する工程と、

(f) 前記(e)工程後に、前記第2の半導体チップ群を構成する複数の半導体チップを熱圧着し、前記第2の接着材を介して前記配線基板の主面上に固定するとともに、前記第2の半導体チップ群を構成する複数の半導体チップそれぞれの複数の突起電極と、前記配線基板の第2の複数の電極とを電気的に接続する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項26】 請求項25記載の半導体装置の製造方法であって、前記(c)工程において、前記第1の接着材は、互いに分離して前記配線基板の主面上に配置される第1および第2の部分を有しており、前記(e)工程において、前記第2の接着材を、前記第1の接着材の、第1の部分と第2の部分の間に配置することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項27】 請求項25記載の半導体装置の製造方法であって、前記(c)工程において、個片化された複数の前記第1の接着材を千鳥配列で配置し、前記(e)工程において、それぞれの前記第1の接着材の隣に個片化された複数の前記第2の接着材を千鳥配列で配置することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項28】 請求項25記載の半導体装置の製造方法であって、前記第1および第2の接着材は、熱硬化性樹脂であって、前記第1の接着材を前記(d)工程において熱硬化させ、前記第2の接着材を前記(f)工程において熱硬化させることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項29】 請求項25記載の半導体装置の製造方法であって、前記第1および第2の接着材は、熱硬化性樹脂によって形成されたフィルムであることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項30】 (a) 主面と、前記主面上に形成された複数の電極とを有する配線基板を準備する工程と、

(b) 主面と、前記主面上に形成された複数の電極および複数の半導体素子とを有する第1の半導体チップを準備する工程と、

(c) 前記第1の半導体チップを前記配線基板の主面上に第1の接着材を介して配置する工程と、

(d) 前記第1の接着材に熱処理を施して硬化させ、前記第1の半導体チップを前記第1の接着材を介して前記配線基板の主面上に固定する工程と、

(e) 主面と、前記主面上に形成された複数の電極および複数の半導体素子とを有する第2の半導体チップを準備する工程と、

(f) 前記(d)工程後に、前記第2の半導体チップを第2の接着材を介して前記第1の半導体チップ上に配置する工程と、

(g) 前記第 2 の半導体チップを治具によって保持した状態で、前記第 2 の接着材に熱処理を施して硬化させ、前記第 2 の半導体チップを前記第 2 の接着材を介して前記第 1 の半導体チップ上に固定する工程と、(h) 前記 (g) 工程後に、前記治具を前記第 2 の半導体チップから離す工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3 1】 請求項 3 0 記載の半導体装置の製造方法であって、前記 (d) 工程と (f) 工程の間にさらに、

(i) 主面と、前記主面上に形成された複数の電極および複数の半導体素子とを有する第 3 の半導体チップを準備する工程と、

(j) 前記第 3 の半導体チップを前記配線基板の主面上に第 3 の接着材を介して配置する工程と、

(k) 前記第 3 の接着材に熱処理を施して硬化させ、前記第 3 の半導体チップを前記第 3 の接着材を介して前記配線基板の主面上に固定する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3 2】 請求項 3 1 記載の半導体装置の製造方法であって、前記 (k) 工程後にさらに、

(l) 主面と、前記主面上に形成された複数の電極および複数の半導体素子とを有する第 4 の半導体チップを準備する工程と、

(m) 前記 (d) 工程後に、前記第 4 の半導体チップを第 4 の接着材を介して前記第 3 の半導体チップ上に配置する工程と、

(n) 前記第 4 の半導体チップを治具によって保持した状態で、前記第 4 の接着材に熱処理を施して硬化させ、前記第 4 の半導体チップを前記第 4 の接着材を介して前記第 3 の半導体チップ上に固定する工程と、

(o) 前記 (g) 工程後に、前記治具を前記第 4 の半導体チップから離す工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3 3】 請求項 3 0 記載の半導体装置の製造方法であって、前記 (d) 工程において、前記第 1 の接着材に施す熱処理の温度は、前記 (g) 工程において、前記第 2 の接着材に施す熱処理の温度よりも高いことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3 4】 (a) 主面と、前記主面上に形成された複数の電極とを有する配線基板を準備する工程と、

(b) 前記配線基板に 100℃以上の熱処理を施す工程と、

(c) 前記 (b) 工程後に、前記配線基板の主面上に接着材を介して半導体チップを配置する工程と、

(d) 前記接着材に熱処理を施し、前記接着材を硬化させて前記半導体チップを前記配線基板の主面上に固定する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3 5】 配線基板の主面上に、第 1 の半導体チ

10

ップ、第 2 の半導体チップおよび第 3 の半導体チップを重ねて搭載した半導体装置の製造方法であって、主面、前記主面の反対側の裏面、および前記主面上に形成された複数の電極を有する配線基板を準備する工程と、

主面と、前記主面上に形成された複数の突起電極を有する第 1 の半導体チップを準備する工程と、

主面と、前記主面上に形成された複数の電極を有する第 2 の半導体チップを準備する工程と、

10 主面と、前記主面上に形成された複数の電極を有する第 3 の半導体チップを準備する工程と、

前記配線基板の主面上に、前記第 1 の半導体チップを、前記第 1 の半導体チップの主面が前記配線基板の主面向き合う様に配置し、前記第 2 の半導体チップを、前記第 2 の半導体チップの裏面が前記第 1 の半導体チップの裏面向き合う様に配置し、前記第 3 の半導体チップを、前記第 3 の半導体チップの裏面が前記第 2 の半導体チップの主面向き合う様に配置し、かつ前記複数の突起電極を介して前記第 1 の半導体チップと前記配線基板の複数の電極を電気的に接続し、前記第 1 の半導体チップの主面と前記配線基板の主面の間を接着材で接着する工程と、

20

前記各半導体チップを配線基板上に配置する工程の後に、前記第 2 の半導体チップの複数の電極と、前記配線基板の複数の電極をそれぞれワイヤを介して電気的に接続する工程と、

前記各半導体チップを配線基板上に配置する工程の後に、前記第 3 の半導体チップの複数の電極と、前記配線基板の複数の電極をそれぞれワイヤを介して電気的に接続する工程とを有しており、

前記各半導体チップを配線基板上に配置する工程において、前記第 3 の半導体チップの複数の電極が、前記第 1 の半導体チップを配置する領域の外側に位置する様に、前記第 3 の半導体チップを配置し、

前記第 3 の半導体チップの複数の電極を電気的に接続する工程において、前記接着材の一部を、前記第 1 の半導体チップの外側に配置された前記第 3 の半導体チップの複数の電極と、前記配線基板の主面との間に、前記第 3 の半導体チップの裏面と前記接着材との間隔が、前記第 3 の半導体チップの厚さよりも小さくなる様に配置した状態で、前記ワイヤを前記第 3 の半導体チップの複数の電極に接続することを特徴とする半導体装置の製造方法。

40

【請求項 3 6】 請求項 3 5 記載の半導体装置の製造方法であって、前記第 1 の半導体チップの主面と、前記配線基板の主面との間に形成された前記接着材の第 1 の部分と、前記第 1 の半導体チップを配置する領域の外側であって、前記第 2 の半導体チップの裏面と、前記配線基板の主面の間に形成された前記接着材の第 2 の部分と、前記第 1 の半導体チップを配置する領域および第 2 の半

50

導体チップを配置する領域の外側であって、前記第3の半導体チップの裏面と、前記配線基板の主面との間に形成された前記接着材の第3の部分とを形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項37】 請求項36記載の半導体装置の製造方法であって、前記接着材の第2の部分は前記接着材の第1の部分よりも厚く、前記接着材の第3の部分は前記接着材の第2の部分よりも厚く形成されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項38】 請求項37記載の半導体装置の製造方法であって、前記各半導体チップを配線基板上に配置する工程は、

前記配線基板の主面上に、前記第1の半導体チップを、前記第1の半導体チップの主面が前記配線基板の主面に向き合う様に熱圧着用治具を用いて熱圧着し、かつ前記複数の突起電極を介して前記第1の半導体チップと前記配線基板の複数の電極を電気的に接続し、前記第1の半導体チップの主面と前記配線基板の主面の間を接着材で接着する工程と、

前記第1の半導体チップを配置する工程の後に、前記第2の半導体チップを、前記第2の半導体チップの裏面が前記第1の半導体チップの裏面に向き合う様に接着する工程と、

前記第2の半導体チップを配置する工程の後に、前記第3の半導体チップを、前記第3の半導体チップの裏面が前記第2の半導体チップの主面に向き合う様に接着する工程とを有していることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項39】 請求項38記載の半導体装置の製造方法であって、前記第1の半導体チップを配置する工程において、前記熱圧着用治具が有する突起部によって、前記接着材の第2の部分と、前記接着材の第3の部分の厚みに差を設けることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項40】 請求項38記載の半導体装置の製造方法であって、前記接着材が熱硬化性樹脂を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項41】 請求項37記載の半導体装置の製造方法であって、前記各半導体チップを配線基板上に配置する工程は、

前記第1の半導体チップの裏面上に、前記第2の半導体チップを、前記第2の半導体チップの裏面が前記第1の半導体チップの裏面に向き合う様に接着する工程と、前記第2の半導体チップを接着する工程の後に、前記配線基板の主面上に、前記第1の半導体チップを、前記第1の半導体チップの主面が前記配線基板の主面に向き合う様に熱圧着用治具を用いて熱圧着し、かつ前記複数の突起電極を介して前記第1の半導体チップと前記配線基板の複数の電極を電気的に接続し、前記第1の半導体チップの主面と前記配線基板の主面の間を接着材で接着す

る工程と、

前記第1の半導体チップを接着する工程の後に、前記第2の半導体チップの主面上に、前記第3の半導体チップを、前記第3の半導体チップの裏面が前記第2の半導体チップの主面に向き合う様に接着する工程とを有していることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項42】 請求項41記載の半導体装置の製造方法であって、前記第2の半導体チップは、前記第1の半導体チップの裏面上に、熱硬化性樹脂を含む接着材を介して接着されており、前記第3の半導体チップは、前記第2の半導体チップの主面上に、熱硬化性樹脂を含む接着材を介して接着されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項43】 配線基板の主面上に、第1の半導体チップ、第2の半導体チップおよび第3の半導体チップを重ねて搭載した半導体装置の製造方法であって、主面、前記主面の反対側の裏面、および前記主面上に形成された複数の電極を有する配線基板を準備する工程と、

主面と、前記主面上に形成された複数の突起電極を有する第1の半導体チップを準備する工程と、

主面と、前記主面上に形成された複数の電極を有する第2の半導体チップを準備する工程と、

主面と、前記主面上に形成された複数の電極を有する第3の半導体チップを準備する工程と、

前記配線基板の主面上に、前記第1の半導体チップを、前記第1の半導体チップの主面が前記配線基板の主面に向き合う様に配置し、前記第2の半導体チップを、前記第2の半導体チップの裏面が前記第1の半導体チップの裏面に向き合う様に配置し、前記第3の半導体チップを、前記第3の半導体チップの裏面が前記第2の半導体チップの主面に向き合う様に配置し、かつ前記複数の突起電極を介して前記第1の半導体チップと前記配線基板の複数の電極を電気的に接続し、前記第1の半導体チップの主面と前記配線基板の主面の間を接着材で接着する工程と、

前記各半導体チップを配線基板上に配置する工程の後に、前記第2の半導体チップの複数の電極と、前記配線基板の複数の電極をそれぞれワイヤを介して電気的に接続する工程と、

前記各半導体チップを配線基板上に配置する工程の後に、前記第3の半導体チップの複数の電極と、前記配線基板の複数の電極をそれぞれワイヤを介して電気的に接続する工程とを有しており、

前記各半導体チップを配線基板上に配置する工程において、前記第3の半導体チップの複数の電極が、前記第2の半導体チップを配置する領域の内側で、かつ前記第1の半導体チップを配置する領域の外側に位置する様に、前記第3の半導体チップを配置し、

前記第3の半導体チップの複数の電極を電気的に接続す

る工程において、前記接着材の一部を、前記第1の半導体チップの外側に配置された前記第3の半導体チップの複数の電極と、前記配線基板の主面との間に、前記第2の半導体チップの裏面と前記接着材との間隔が、前記第3の半導体チップの厚さよりも小さくなる様に配置した状態で、前記ワイヤを前記第3の半導体チップの複数の電極に接続することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造技術に関し、特にスタック構造の半導体装置の小形化に適用して有効な技術に関する。

【0002】

【従来の技術】半導体素子が形成された半導体チップを有する半導体装置（半導体パッケージ）において、複数の半導体チップを1つのパッケージに納めた構造の一例としてスタック構造が知られている。

【0003】スタック構造の半導体装置では、半導体チップを、例えば、2段に積層し、これを樹脂モールドしてパッケージとしている。

【0004】なお、スタック構造の半導体装置とその製造方法については、例えば、特開平2000-188369号公報、特開平2000-299431号公報および特開平11-219984号公報にその記載がある。特開平2000-188369号公報に開示されているように、フェースアップ実装され、ワイヤボンディング接続されたチップの上にさらに別のチップを積層して実装する構造においては、上のチップが下のチップの電極を覆わない形状である必要があり、チップサイズの制約が大きい。

【0005】これに比較して、特開平2000-299431号公報や特開平11-219984号公報に開示されているように、下層の半導体チップがフェースダウン実装によるフリップチップ接続、かつ、上層の半導体チップがフェースアップ実装によるワイヤボンディング接続される構造においては、前記のようなチップサイズの制約は無く、より自由度の高い構造となる。

【0006】そのうち、特開平2000-299431号公報には、上層の半導体チップの一部が突出する構造の半導体装置における上層の半導体チップのワイヤボンディング性の向上を図る技術が記載されている。

【0007】また、特開平11-219984号公報には、チップ積層構造を有し、かつSMT（Surface Mount Technology）によって、厚膜配線基板上に実装することができる半導体装置パッケージおよびその製造方法について記載されている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】ところが、スタック構造の半導体装置を携帯電話器などの携帯機器に実装する

場合、半導体装置の小形化とともに、薄形化も要求される。しかしながら、さらなる半導体装置の薄形化を追求するにあたって、チップ強度の低下という新たな課題が発生した。

【0009】また、配線基板上に実装した半導体チップを樹脂封止する手段として、トランスファーモールド法を採用するのが生産性を向上するために望ましい。しかし、前記チップ積層構造にトランスファーモールド法を採用するにあたって、ボイドの発生という、また別の新たな課題が発生した。

【0010】本発明の目的は、薄形化を図るスタック構造の半導体装置およびその製造方法を提供することにある。

【0011】また、本発明のその他の目的は、チップサイズの制約を低減するスタック構造の半導体装置およびその製造方法を提供することにある。

【0012】さらに、本発明のその他の目的は、樹脂封止時のボイド発生やチップ割れを防止するスタック構造の半導体装置およびその製造方法を提供することにある。

【0013】本発明の前記ならびにその他の課題、および目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明かになるであろう。

【0014】

【課題を解決するための手段】本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0015】すなわち、本発明は、配線基板上に第1の半導体チップと、これの上に前記第1の半導体チップより薄い第2の半導体チップとが積層された半導体装置であり、第1の半導体チップは、その主面の電極が配線基板の電極と対向するように、第1の半導体チップの主面と配線基板の主面とが向かい合って配置され、第2の半導体チップは、配線基板の主面上に第1の半導体チップを介して配置されているものである。

【0016】さらに本願のその他の発明の概要を項に分けて簡単に示す。すなわち、

1. 互いに向かい合う第1および第2の側面と、前記第1および第2の側面と接しており、互いに向かい合う第3および第4の側面を有するキャビティ、および前記第1の側面上に形成された樹脂注入口を持つ金型を準備する工程と、主面を有する配線基板、前記配線基板の主面上に固定された第1の半導体チップ、前記第1の半導体チップの上に固定された第2の半導体チップを準備する工程と、前記配線基板、前記第1および第2の半導体チップを前記キャビティの内部に配置する工程と、前記第1および第2の半導体チップを配置後、前記樹脂注入口より樹脂を注入して、前記第1および第2の半導体チップを封止する工程とを有する半導体装置の製造方法であり、前記第1および第2の半導体チップを配置する工程

において、前記キャビティの第3の側面と平行な断面において、前記第1の半導体チップの長さは、前記第2の半導体チップの長さよりも長くなるように、前記配線基板、第1および第2の半導体チップを配置するものである。

2. 互いに向かい合う第1および第2の側面と、前記第1および第2の側面と接しており、互いに向かい合う第3および第4の側面を有するキャビティ、および前記第1の側面上に形成された複数の樹脂注入口を持つ金型を準備する工程と、主面を有するとともに複数のデバイス領域が形成された配線基板、前記配線基板の複数のデバイス領域のそれぞれに固定された第1の半導体チップ、前記第1の半導体チップ上に固定された第2の半導体チップを準備する工程と、前記配線基板、前記複数の第1および第2の半導体チップを前記キャビティの内部に配置して前記複数のデバイス領域を前記キャビティによって一括で覆う工程と、前記複数のデバイス領域を前記キャビティによって一括で覆う工程後、それぞれのデバイス領域に対応した複数の樹脂注入口より樹脂を注入して、前記複数の第1および第2の半導体チップを一括で封止する工程とを有する半導体装置の製造方法であり、前記複数のデバイス領域を前記キャビティによって一括で覆う工程において、前記キャビティの第3の側面と平行な断面において、それぞれの前記第1の半導体チップの長さは、前記第1の半導体チップに積層された前記第2の半導体チップの長さよりも長くなるように、前記配線基板、前記複数の第1および第2の半導体チップを配置するものである。

【0017】

【発明の実施の形態】以下の実施の形態では特に必要なき以外は同一または同様な部分の説明を原則として繰り返さない。

【0018】さらに、以下の実施の形態では便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある。

【0019】また、以下の実施の形態において、要素の数など（個数、数値、量、範囲などを含む）に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合などを除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良いものとする。

【0020】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。

【0021】（実施の形態1）図1は本発明の実施の形態1の半導体装置（スタック構造のCSP）の構造の一

例を示す断面図、図2は図1に示すCSPの構造を示す部分断面図、図3は図1に示すCSPの組み立てにおけるウェハへのダイボンドフィルム貼り付け状態の一例を示す部分断面図、図4は図1に示すCSPの組み立てにおけるウェハダイシングの一例を示す部分断面図、図5は図1に示すCSPの組み立ての一例を示す部分断面図であり、（a）は第1チップマウントを示す図、（b）は第1チップ熱圧着を示す図、図6は図1に示すCSPの組み立ての一例を示す部分断面図であり、（a）は第2チップマウントを示す図、（b）は第2チップワイヤボンディングを示す図である。

【0022】図1、図2に示す本実施の形態1の半導体装置は、個片基板3（配線基板）上に2つの半導体チップが積層されたスタック構造のものであるとともに、個片基板3のチップ支持面3a（主面）側において第1の半導体チップ1とこれに積層された第2の半導体チップ2とが樹脂モールドによって封止された樹脂封止形のものである。

【0023】さらに、前記半導体装置は、チップサイズと同等か、もしくはそれより若干大きい程度の半導体パッケージである。すなわち、前記半導体装置は、スタック構造のCSP9である。

【0024】また、個片基板3のチップ支持面3aと反対側の面（以降、裏面3bという）には、外部端子であり、かつ突起電極である複数の半田ボール11がマトリクス配置で設けられている。

【0025】なお、本実施の形態1のCSP9は、図13に示すような複数（ここでは、例えば、3個×13個＝39個のマトリクス配列）のデバイス領域7aが形成された配線基板である多数個取り基板7を用いて、ダイシングライン7bによって区画形成された複数のデバイス領域7aを一括に覆う状態で樹脂モールドシ（以降、これを一括モールドという）、これによって形成された図27（b）に示す一括モールド部8をモールド後にダイシングして個片化したものである。

【0026】CSP9の詳細構造を説明すると、主面であるチップ支持面3aおよび裏面3bを有しており、かつチップ支持面3a上に図8に示すような複数の接続端子3c（電極）を有するとともに、裏面3b上に複数の半田ボール11を有する個片基板3と、主面1bおよび裏面1cを有しており、かつ主面1b上に複数のパッド1a（電極）と複数の半導体素子とを有する第1の半導体チップ1と、主面2bおよび裏面2cを有しており、かつ主面2b上に複数のパッド2a（電極）と複数の半導体素子とを有するとともに、第1の半導体チップ1より厚さの薄い第2の半導体チップ2と、個片基板3のチップ支持面3a上に形成されており、かつ第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2を封止する樹脂封止体6と、第2の半導体チップ2のパッド2aとこれに対応する個片基板3の接続端子3cとを接続する複数の

10

20

30

40

50

ワイヤ4とからなる。

【0027】さらに、第1の半導体チップ1は、個片基板3のチップ支持面3a上に第1の半導体チップ1の複数のパッド1aが個片基板3の接続端子3cと対向するように、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとが向かい合って配置されている。

【0028】その際、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとの間は、薄膜のNCF（非導電フィルム：Non-Conductive Film）12などの接着材を介して固定されている。

【0029】ただし、前記接着材としては、NCF12以外のACF（異方性導電フィルム：Anisotropic Conductive Film）などを用いてもよく、あるいは、その他の接着材を用いてもよい。

【0030】ここで、NCF12もしくはACFは、主に、フリップチップ接続を行う際に用いられる接着材であり、エポキシ樹脂を主成分とする熱硬化性の樹脂によって形成されたテープ状のフィルムである。

【0031】また、第1の半導体チップ1の複数のパッド1aは、これに対応する個片基板3の複数の接続端子3cと圧接している。

【0032】その際、第1の半導体チップ1のパッド1aに設けられた突起電極である金バンプ1dと、個片基板3の接続端子3cとが圧接されている。

【0033】なお、金バンプ1dは、金線を用いてワイヤボンディング技術を利用して半導体チップの電極に設けられた突起電極であり、CSP9の組み立てにおいては、予め、第1の半導体チップ1のパッド1aに設けておく。

【0034】一方、第2の半導体チップ2は、個片基板3のチップ支持面3a上に第1の半導体チップ1を介して配置されており、第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2は、ダイボンドフィルム材5（接着材）を介してお互いの裏面1c、2cが向かい合って個片基板3のチップ支持面3a上に配置されている。

【0035】すなわち、CSP9は、スタック構造において、下層側の第1の半導体チップ1が個片基板3に対してフェースダウン実装でフリップチップ接続され、一方、上層側の第2の半導体チップ2は、第1の半導体チップ1の裏面1cにフェースアップ実装されてワイヤボンディング接続されており、その際、図2に示すように、上層側の第2の半導体チップ2の厚さ（ t_2 ）が、下層側の第1の半導体チップ1の厚さ（ t_1 ）より薄くなっている（ $t_1 \geq t_2$ ）。

【0036】例えば、 $t_1 = 240 \mu\text{m}$ 、 $t_2 = 180 \mu\text{m}$ などであるが、ただし、これらの数値に限定されるものではない。

【0037】ここで、本実施の形態1のCSP9の特徴である第2の半導体チップ2の厚さを第1の半導体チップ1の厚さより薄くすることについての説明をする。

【0038】例えば、携帯電話器などの携帯機器に用いられる半導体素子は、その実装高さが低いことが要求される。そのために、半導体チップは薄く加工されたものを使用する必要がある。近年の薄形半導体素子に用いられる半導体チップは $200 \mu\text{m}$ 以下の厚さに加工されたものが多い。

【0039】一般的に、半導体チップの荷重に対する割れやすさは、半導体チップの厚さが薄いほど顕著になる。したがって、本実施の形態1のCSP9では、大きな荷重が加わる第1の半導体チップ1を厚くし、第2の半導体チップ2を第1の半導体チップ1より薄くしている。

【0040】例えば、第1の半導体チップ1を熱圧着する際の荷重が $10 \sim 20 \text{ kgf}$ であり、第2の半導体チップ2を熱圧着する際の荷重は 1 kgf である。

【0041】このように、第1の半導体チップ1を熱圧着する荷重を、第2の半導体チップ2を熱圧着する荷重よりも大きくするのは以下のような理由がある。

【0042】第1の半導体チップ1の実装工程には、図5（b）に示すように、熱圧着ヘッド20からの圧力によって、金バンプ1dが配線基板3（個片基板）上の接続端子3cと圧接した状態で熱を加え、熱硬化性樹脂を硬化させて金バンプ1dと接続端子3cとの接続を確保するものである。この時、金バンプ1dの高さにばらつきが生じた場合でも、金バンプ1dと接続端子3cとの接続を確実に確保するためには、熱圧着ヘッド20から加える圧力によって、金バンプ1d、接続端子3c、もしくは接続端子3cの下配線基板3を弾性または塑性変形させることが有効である。

【0043】このように、金バンプ1dを介して配線基板3上の接続端子3cと接続する第1の半導体チップ1の接続信頼性を確保するためには、大きな圧着力が必要であり、第1の半導体チップ1には、こうした圧着力に耐えるだけの強度、すなわちチップの厚さが必要となる。

【0044】これに比較して、フェースアップ実装され、ワイヤ4を介して接続端子3cと接続する第2の半導体チップ2を第1の半導体チップ1上に配置する際に加える圧力を小さくすることで、第2の半導体チップ2を薄くしても、チップ割れの不良を防ぐことができる。

【0045】これにより、第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2の両者とも、実装荷重によって割れることなく、また、接続端子3cとの接続信頼性を低下させることもなく、CSP9の薄形化を図って所望の実装高さを実現できる。

【0046】また、下層側の第1の半導体チップ1をフェースダウン実装でフリップチップ接続することにより、第1の半導体チップ1の裏面1cに積層される第2の半導体チップ2の平面方向の大きさを第1の半導体チップ1より小さくすることも、あるいは大きくすること

も可能になり、チップサイズの制約を大幅に低減できる。

【0047】これにより、スタック構造において、チップサイズの組み合わせの自由度が広がり、小形のマルチチップモジュールを実現できる。

【0048】また、CSP9では、第1の半導体チップ1のバス周波数は、第2の半導体チップ2のバス周波数よりも大きくなっている。

【0049】その際、第1の半導体チップ1をロジックチップとし、また、第2の半導体チップ2をメモリチップとする。

【0050】これは、第1の半導体チップ1であるロジックチップを下層側にフェースダウン実装して、金バンプ1dを介して個片基板3の接続端子3cと接続することによって、入出力部のインダクタンスを抑えることができるためである。

【0051】その結果、出力信号に乗るノイズを抑えつつ、バス周波数を大きくすることができ、ロジックチップの性能をシステムが要求する十分な値にまで引き出すことができる。

【0052】なお、ロジックチップと比較して、第2の半導体チップ2であるメモリチップは、ノイズの発生を抑えるために電流の時間変化量を制限した範囲でも、要求される性能を十分に発揮することができるとともに、ロジックチップ（第1の半導体チップ1）とメモリチップ（第2の半導体チップ2）とを積層することによってCSP9の小形化を実現できる。

【0053】なお、図15に示すように、第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2は、例えば、シリコンなどによって形成され、かつそれぞれの主面1b、2bには半導体集積回路が形成されるとともに、主面1b、2bの周縁部には接続用の電極である複数のパッド1a、2aが形成されている。

【0054】また、樹脂封止体6の形成に用いられるモールド用の樹脂は、例えば、熱硬化性のエポキシ樹脂などである。

【0055】さらに、個片基板3は、例えば、ガラス入りエポキシ基板である。

【0056】なお、個片基板3には、そのチップ支持面3aに、ワイヤ4および金バンプ1dとの接続を図る複数の接続端子3cが形成され、また、その裏面3bには、半田ボール11が搭載される図14(b)に示すような複数のバンプランド3dが露出して配置されている。

【0057】また、ワイヤボンディングによって接続されるワイヤ4は、例えば、金線である。

【0058】さらに、個片基板3の各接続端子3cに導通して接続された外部端子である複数の半田ボール3は、個片基板3の裏面3bにマトリクス配置で設けられている。

【0059】次に、本実施の形態1のCSP9の製造方法の概要について説明する。

【0060】なお、ここでは、CSP9の製造工程のうち、図3と図4に示す半導体チップ形成工程、図5

(a)に示す第1の半導体チップマウント工程、図5

(b)に示す第1の半導体チップ熱圧着工程、図6

(a)に示す第2の半導体チップマウント工程および図6(b)に示すワイヤボンディング工程について説明する。

【0061】まず、チップ支持面3a上に複数の接続端子3cを有する個片基板3（配線基板）を準備する。

【0062】さらに、第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2を準備する。

【0063】すなわち、主面1bおよび裏面1cを有し、かつ主面1b上に複数のパッド1aおよび複数の半導体素子を有する第1の半導体チップと、同様に、主面2bおよび裏面2cを有し、かつ主面2b上に複数のパッド2aおよび複数の半導体素子を有するとともに、第1の半導体チップ1より薄い第2の半導体チップ2とを準備する。

【0064】その際、第1の半導体チップ1上に積層させる第2の半導体チップ2については、図3に示すように、予め半導体ウェハ17の状態での裏面17bにダイボンドフィルム材5を貼り付けておき、その後、ダイシングによって個片化して第2の半導体チップ2を取得する。

【0065】まず、第2の半導体チップ2形成用の半導体ウェハ17の主面（回路面）17aの反対側の裏面17bをバックグラインドにより、所望の厚さに研削した後、エポキシ樹脂などからなるダイボンドフィルム材5を半導体ウェハ17の裏面17b全体に貼り付ける。

【0066】すなわち、120℃に加熱されたステージ18上に、主面17aを下に向けた半導体ウェハ17を載置する。その際、120℃は、ダイボンドフィルム材5が硬化をしない温度で、かつダイボンドフィルム材5が半導体ウェハ17に密着しやすい温度である。

【0067】その後、半導体ウェハ17の裏面17bにダイボンドフィルム材5をかぶせ、ローラ14をダイボンドフィルム材5の上から半導体ウェハ17上で転がし、気泡を押し出しながら貼り付ける。

【0068】続いて、半導体ウェハ17からはみ出しているダイボンドフィルム材5を切り落とし、さらに、ダイボンドフィルム材5に添付されている保護シート15を剥離する。

【0069】その後、図4に示すように、ダイボンドフィルム材5が貼られた半導体ウェハ17を、固定リング19によって支持されたダイシング用のUVテープであるダイシングテープ16に貼り付ける。

【0070】その後、ダイシングブレード10を用いてダイシングを行って半導体ウェハ17を切り分け（個片

化)、これによって、第2の半導体チップ2を取得する。

【0071】その際、ダイシングブレード10の切り込みは、ダイシングブレード10がダイボンドフィルム材5を完全に切る深さまで行う。これは、次の工程であるダイボンド工程において、ダイボンドフィルム材5が切れていないと、半導体チップをダイシングテープ16から剥がす際に、半導体チップのみが突き上げられて半導体チップからダイボンドフィルム材5が剥がれてしまうことを防ぐためである。

【0072】以上のように、半導体ウェハ17の裏面17b全体に一括でダイボンドフィルム材5を貼った後にダイシングして個々の第2の半導体チップ2を取得することにより、個片化された半導体チップに後からダイボンドフィルム材5を貼る場合と比べて、作業性が向上し、コストダウンを図ることができる。

【0073】その後、図5(a)に示す第1の半導体チップ1のマウントを行う。

【0074】なお、第1の半導体チップ1の複数のパッド1aのそれぞれは、第1の半導体チップ1の主面1b上に形成されたパッド1aと、パッド1a上に配置された突起電極である金バンプ1dとによって構成される。

【0075】まず、第1の半導体チップ1の主面1bを個片基板3のチップ支持面3aに向かい合わせ、第1の半導体チップ1の複数のパッド1aが個片基板3の複数の接続端子3cと対向するように第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に配置する。

【0076】その後、第1の半導体チップ1の裏面1cに圧力を加えて第1の半導体チップ1の複数のパッド1aと個片基板3の複数の接続端子3cとを電気的に接続する。

【0077】その際、まず、図5(a)に示すように、個片基板3のチップ支持面3aの第1の半導体チップ1搭載エリアに第1の半導体チップ1より若干大きめに切断したNCF12(接着材)を配置し、続いて、第1の半導体チップ1のパッド1aが個片基板3の接続端子3cと対向するように、かつパッド1aとこれに対応する接続端子3cとを位置決めして第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に配置し、その後、第1の半導体チップ1の裏面1cに1~5Kg程度の極僅かな荷重を付与する。

【0078】これにより、金バンプ1dがNCF12につきささり、第1の半導体チップ1が個片基板3上に仮固定される。

【0079】その後、図5(b)に示すように、熱圧着ヘッド20によって第1の半導体チップ1の裏面1cに圧力を加える。また、前記圧力と同時に熱圧着ヘッド20から熱も加える。

【0080】これによって、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとの間でNCF

12の熱硬化性樹脂を硬化させ、前記熱硬化性樹脂を介して第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に固定する。

【0081】なお、熱圧着ヘッド20は、その加圧面が、個片基板3とほぼ同じ程度の大きさのものである。

【0082】熱圧着では、個片基板3を70℃前後に加熱されたダイボンドステージ21上に載置し、第1の半導体チップ1の裏面1cを300℃前後に加熱された熱圧着ヘッド20で加圧する。この際に加圧荷重は、第1の半導体チップ1の1バンプあたり50~100gf程度である。例えば、CSP9が200バンプのものであれば、10~20kgf程度の荷重を熱圧着ヘッド20によって第1の半導体チップ1に付与する。

【0083】その結果、NCF12が200℃前後の温度となり、熔融・硬化することにより、第1の半導体チップ1のパッド1a上の金バンプ1dと、個片基板3の接続端子3cとが接触して電気的に導通する。

【0084】この際、特に詳細には図示しないが、前記熱圧着ヘッド20からの加圧荷重によって、金バンプ1d、接続端子3c、もしくは接続端子3cの下の配線基板3を弾性または塑性変形させた状態で熱硬化性樹脂を硬化させるため、金バンプ1dの高さにばらつきが有る場合、もしくは、第1の半導体チップ1または第2の半導体チップ2動作時の発熱によって、熱硬化性樹脂が熱膨張した場合でも、金バンプ1dと接続端子3c間の接続信頼性を十分に確保することができる。

【0085】なお、第1の半導体チップ1のフリップチップ接続が、例えば、金-金接続で行われる場合、すなわち、個片基板3の接続端子3cの表面に金めっきが施されている場合には、NCF12やACFなどのフィルム状の接着材は使用せずに、第1の半導体チップ1に圧力と同時に超音波を加えて超音波金-金接続によって第1の半導体チップ1と個片基板3とを接続することも可能である。

【0086】その場合、第1の半導体チップ1の主面1bの保護、接続信頼性の確保、モールド時のチップ割れの防止のため、チップ接続後、個片基板3と第1の半導体チップ1との間に絶縁性の樹脂を流し込んでアンダーフィル封止を行う。

【0087】次に、図6(a)に示す第2の半導体チップ2のマウントを行う。

【0088】その際、第1の半導体チップ1の裏面1c上に第1の半導体チップ1よりは厚さが薄く形成された第2の半導体チップ2を、第1の半導体チップ1の裏面1cと第2の半導体チップ2の裏面2cとがダイボンドフィルム材5を介して向かい合うように配置するとともに、圧着ヘッド(常温)によって第1の半導体チップ1のダイボンドの際に付与した圧力(CSP9が200バンプの場合、10~20kgf程度の荷重)より小さな圧力を加えつつ配置する。

【0089】すなわち、第2の半導体チップ2の裏面2cには、予めダイボンドフィルム材5が貼り付けられているため、フリップチップ接続された第1の半導体チップ1の裏面1cに、熱と小さな荷重とによってダイボンドフィルム材5を接着材として第2の半導体チップ2を固着する。また、この際、ダイボンドフィルム材5を硬化させるための加熱は、ダイボンドステージ21によって行い、前記圧着ヘッドの温度はダイボンドステージ21の温度よりも低く、例えば、常温に設定するのが良い。

【0090】なお、その際の荷重（圧力）は、CSP9の第2の半導体チップ2の主面2bの大きさが、例えば、50mm²程度の場合、1kgf程度で、かつ、温度は160℃程度である。

【0091】その後、図6（b）に示すように、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aとそれぞれに対応する個片基板3の複数の接続端子3cとをワイヤボンディングによる金線のワイヤ4を介して電氣的に接続する。

【0092】続いて、第1の半導体チップ1、第2の半導体チップ2および複数のワイヤ4を樹脂封止する。

【0093】すなわち、個片基板3のチップ支持面3a側において、トランスファーモールドによって第1の半導体チップ1、第2の半導体チップ2および複数のワイヤ4を樹脂封止して樹脂封止体6を形成する。

【0094】その後、個片基板3の裏面3b上に、個片基板3の複数の接続端子3cと電氣的に接続する複数の突起電極である半田ボール11を搭載する。

【0095】すなわち、個片基板3の樹脂封止体6が形成された側と反対側の裏面3bに露出する各バンプランド3dに、半田ボール11をリフローなどによって搭載してCSP9の外部電極を形成する。

【0096】（実施の形態2）図7は本発明の実施の形態2の半導体装置（スタック構造のCSP）の構造の一例を示す部分断面図、図8は図7に示すCSPの組み立てにおけるワイヤリング状態の一例を示す拡大平面図、図9は図7に示すCSPの組み立ての一例を示す部分断面図であり、（a）は第1チップマウントを示す図、

（b）は第1チップ熱圧着を示す図、図10は図7に示すCSPの組み立ての一例を示す部分断面図であり、

（a）は第2チップマウントを示す図、（b）は第2チップワイヤボンディングを示す図である。

【0097】また、図11は本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立て手順における全工程の一例を示す製造プロセスフロー図、図12は本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立て手順における詳細工程の一例を示す製造プロセスフロー図、図13は本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立てにおける多数個取り基板の構造の一例を示す平面図、図14は図13に示す多数個取り基板の一部を拡大して示す拡大図であり、（a）は図13のA部の詳細を示す平面図であり、（b）は

（a）の裏面側の底面図、図15は本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立てに用いられる第1および第2の半導体チップの平面図であり、（a）は第1の半導体チップの図、（b）は第2の半導体チップの図、図16は図15に示す第1の半導体チップの構造の一例を示す図であり、（a）は拡大側面図、（b）は拡大部分平面図、図17は本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立てにおける第1のNCF貼り付け工程の一例を示す平面図、図18は図17に示す第1のNCF貼り付け

10 工程の詳細を示す平面図であり、（a）はNCF配置前の図、（b）はNCF貼り付け後の図、図19は図17に示す第1のNCF貼り付けに対する第1の半導体チップの配置状態を示す図であり、（a）は第1の半導体チップ配置状態の図、（b）はコレットによる押圧状態を示す図、図20は第1の半導体チップのダイボンド方法の一例を示す図であり、（a）は第1の半導体チップマウント状態の図、（b）は第1の半導体チップ熱圧着後の図、図21は図17に示す第1のNCF貼り付けに対する第1の半導体チップのダイボンド後の構造の一例を示す平面図、図22は図17に示す第1のNCF貼り付けに対する第2のNCF貼り付け後の構造の一例を示す平面図、図23は図22に示す第2のNCF貼り付けに対する第1と第3の半導体チップの実装完了構造を示す図であり、（a）は平面図であり、（b）は（a）のB部の詳細を示す拡大部分平面図、図24は図22に示す第2のNCF貼り付けに対する第2と第4の半導体チップのダイボンド後の構造の一例を示す平面図、図25は第2と第4の半導体チップのワイヤボンディング後の構造を示す図であり、（a）は平面図であり、（b）は

30 （a）のC部の詳細を示す拡大部分平面図、図26は第2の半導体チップのワイヤボンディング状態の一例を示す平面図であり、（a）はワイヤボンディング前の図、（b）はワイヤボンディング後の図、図27は一括モールドが行われる多数個取り基板の構造の一例を示す平面図であり、（a）は一括モールド前の図、（b）は一括モールド後の図、図28は本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立ての一括モールド方法における樹脂流入方向の一例を示す平面図、図29は図28に示す一括モールド方法の一例を示す図であり、（a）は図28のD-D線に沿った断面の一括モールド時の部分断面図、

（b）は図28のE-E線に沿った断面の一括モールド時の部分断面図、図30は図28に示す一括モールド方法に対する変形例の一括モールド方法における樹脂流入方向の一例を示す平面図、図31は図30に示す変形例の一括モールド方法を示す図であり、（a）は図30のF-F線に沿った断面の一括モールド時の部分断面図、

（b）は図30のG-G線に沿った断面の一括モールド時の部分断面図、図32は本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立てにおける一括モールド後の多数個取り基板の構造の一例を示す平面図、図33は本発明の実施

の形態2の半導体装置の組み立ての第1のNCF貼り付け工程に対する変形例の第1のNCF貼り付け工程を示す平面図、図34は図1に示すスタック構造のCSPに対する変形例のCSPの構造を示す断面図である。

【0098】本実施の形態2は、実施の形態1で説明したCSP9もしくは本実施の形態2で説明するCSP22の組み立てにおける特徴部分を説明するものである。

【0099】本実施の形態2のCSP22は、スタック構造のものであり、実施の形態1のCSP9と同様に、下層側の第1の半導体チップ1がフェースダウン実装でフリップチップ接続され、かつ第1の半導体チップ1に積層される第2の半導体チップ2がフェースアップ実装でワイヤボンディング接続されるとともに、第1の半導体チップ1より第2の半導体チップ2の方がその厚さが薄いものであるが、実施の形態1との相違点は、図7に示すように、第2の半導体チップ2の対向する少なくとも2辺が、第1の半導体チップ1の外周より平面的に突出してはみ出している（オーバーハングしている）点である。

【0100】すなわち、図9（a）に示すNCF12（ACFも同じ）は、熱圧着する際に、一度溶融して液状になる。

【0101】その後、図9（b）に示すように、熱圧着ヘッド20によって10〜20kgf程度の荷重が第1の半導体チップ1の裏面1cにかかる、第1の半導体チップ1の下にNCF12は押し出されて、第1の半導体チップ1の端部よりはみ出る。

【0102】その後、NCF12は硬化して所望の厚さになる。その際、第1の半導体チップ1の端部からはみ出す量は、初期のNCF12の厚さから圧着後の厚さを差し引いた余り分である。はみ出したNCF12は、第1の半導体チップ1の側面に沿って這い上がり、第1の半導体チップ1の裏面1cまで到達する。

【0103】そこで、熱圧着ヘッド20を第1の半導体チップ1の大きさより大きくしておくことにより、図9（b）に示すように、第1の半導体チップ1の裏面1cと同一の高さでNCF12のはみ出した箇所に平坦部12aを形成できる。

【0104】この平坦部12aの長さは、初期のNCF12の厚さを変えることにより、調整可能である。

【0105】その後、図10（a）に示すように、第1の半導体チップ1の裏面1cへの第2の半導体チップ2の積層を行って第2の半導体チップ2のマウントを行う。

【0106】さらに、第2の半導体チップ2のマウント後、図10（b）に示すように、ワイヤボンディングを行って第2の半導体チップ2のパッド2aと個片基板3の接続端子3cとをワイヤ4によって電気的に接続する。

【0107】なお、第2の半導体チップ2のマウントと

ワイヤボンディングの方法については、実施の形態1で説明した第2の半導体チップ2のマウント方法およびワイヤボンディング方法と同じである。

【0108】CSP22の組み立てを図11に示す製造プロセスフロー図にしたがって説明する。

【0109】なお、図12に示す製造プロセスフロー図は、図11の製造プロセスフロー図をさらに詳しく示したものである。

【0110】まず、図14（a）に示すようにチップ支持面3aおよびチップ支持面3a上に形成された複数の第1接続端子3e（第1の電極）および複数の第2接続端子3f（第2の電極）を有する図13に示す配線基板である多数個取り基板7を準備する。

【0111】ここでは、多数個取り基板7の1つのデバイス領域7aおよびこれと千鳥配列のデバイス領域7aにおける第1の半導体チップ1と接続する電極を第1接続端子3eとし、このデバイス領域7aと隣接する他の千鳥配列のデバイス領域7aの第3の半導体チップと接続する電極を第2接続端子3fとする。

【0112】なお、本実施の形態2における図23に示す第3の半導体チップ26は、第1の半導体チップ1と同じ構造で、かつ、下層側に配置されるものである。

【0113】また、図14（a）に示すそれぞれの個片基板3となるデバイス領域7aの裏面3b側には、図14（b）に示すようなバンプランド3dがマトリクス配列で露出している。

【0114】続いて、主面1bおよび主面1b上のパッド1aに形成された複数の金バンプ1dと、複数の半導体素子とを有する図15（a）に示す複数の第1の半導体チップ1、および、主面2bおよび主面2b上に形成された複数のパッド2aと、複数の半導体素子とを有する図15（b）に示す複数の第2の半導体チップ2をそれぞれ準備する。

【0115】なお、第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2の準備については、図11に示すように、第1の半導体チップ1では、ステップS21のバックグラインド、ステップS22のダイシング、ステップS23の治具詰めおよびステップS24の金（Au）バンプ形成を実施の形態1で説明した方法で行って図16（a）、（b）に示すように準備し、一方、第2の半導体チップ2では、ステップS31のバックグラインド、ステップS32のダイボンドフィルム貼り付けおよびステップS33のダイシングを実施の形態1で説明した方法で行って準備する。

【0116】また、多数個取り基板7については、準備後、まず、図12の製造プロセスフロー図の工程NO. 8に示す基板ベークを行う。

【0117】ここでは、多数個取り基板7に100℃以上（例えば、125℃でベーク時間4時間程度である）の熱処理を行う。

【0118】これは、エポキシ系の樹脂基板は、水分を吸収しやすいため、この水分を除去するための処理であり、これにより、第1の半導体チップ1の熱圧着時、多数個取り基板7に気泡が形成されることを防止できるとともに、水分含有による密着性の低下を防ぐことができる。

【0119】したがって、前記ベーク処理後に多数個取り基板7のチップ支持面3a上にNCF12などの接着材を介して第1の半導体チップ1を配置し、その後、前記接着材を熱処理して硬化させて第1の半導体チップ1を多数個取り基板7上に固定する手順となる。

【0120】次に、図11のステップS1に示すNCFの貼り付けを行う。

【0121】ここでは、第1の接着材として第1NCF12bを用い、多数個取り基板7の千鳥配列のそれぞれのデバイス領域7aの図18(a)に示す複数の第1接続端子3e上に、図18(b)に示すように第1NCF12bを配置する。

【0122】なお、第1NCF12bは、互いに分離して多数個取り基板7のデバイス領域7a上に配置される第1および第2の部分をも有している。

【0123】ここでは、一例として、図17に示すように、個片化(前記第1および第2の部分)された複数の第1NCF12bを千鳥配列で配置する。

【0124】さらに、図19(a)、図20(a)に示すように、千鳥配列で配置された複数の第1NCF12bのうちの何れか1つ(例えば、角部に配置された第1NCF12b)の上に第1の半導体チップ1を配置し、熱圧着によって第1の半導体チップ1を固定する。すなわち、図11に示すステップS2の第1の半導体チップ1のフリップチップ搭載を行って、さらに、ステップS3に示す熱圧着を行う。

【0125】前記熱圧着の際には、図19(b)に示すように、70℃程度に加熱されたダイボンドステージ21上で、315℃程度に加熱された熱圧着ヘッド20によって第1の半導体チップ1の裏面1cから荷重を加えて熱圧着する。

【0126】これによって、図19(b)、図20(b)に示すように第1の半導体チップ1は第1NCF12bを介して固定されて、第1の半導体チップ1の複数の金パンプ1dと多数個取り基板7のデバイス領域7aの第1接続端子3eとが電気的に接続するとともに、第1NCF12bは第1の半導体チップ1の外周にはみ出した状態となる。

【0127】なお、図19(a)に示す点線で囲んだ範囲Pは、熱圧着ヘッド20からの熱の影響で、基板温度が第1NCF12bの熱硬化性樹脂を硬化させる程度まで上昇する範囲を示しており、複数の第1NCF12bを千鳥配列などの配列で配置する際には、それぞれの隣接する第1NCF12bが範囲Pに入らないように配置

しなければならない。

【0128】すなわち、熱圧着ヘッド20からの熱の影響を回避可能な程度の間隔をそれぞれに持って複数の第1NCF12bを千鳥配列などの配列で配置する。

【0129】これにより、熱圧着ヘッド20からの熱の影響で、隣接する第1NCF12bの熱圧着前の熱硬化を防ぐことができるとともに、範囲Pに入らない程度にあるまとまった数の第1NCF12bを配置してそれぞれの上に第1の半導体チップ1配置後、連続して第1の半導体チップ1を複数個熱圧着することにより、第1の半導体チップ1のマウント処理を効率良く行うことができる。

【0130】このようにして、図21に示すように、千鳥配列で第1の半導体チップ1の熱圧着を完了させる。

【0131】その後、多数個取り基板7のデバイス領域7aのうち、第1の半導体チップ1を搭載した千鳥配列のデバイス領域7aに隣接するまだ第1の半導体チップ1を搭載していない他の千鳥配列のデバイス領域7aの複数の第2接続端子3f上に第2NCF12c(第2の接着材)を配置する。

【0132】すなわち、図22に示すように、千鳥配列の第1の半導体チップ1のそれぞれの隣に、個片化された複数の第2NCF12cを同じく千鳥配列で配置する。

【0133】その後、図22に示すように、千鳥配列で配置された第2NCF12c上に図23に示す複数の第3の半導体チップ26を搭載し、この第3の半導体チップ26を前記同様の方法で熱圧着ヘッド20により熱圧着する。

【0134】その結果、第2NCF12cを介して複数の第3の半導体チップ26が多数個取り基板7の複数のデバイス領域7aのチップ支持面3a上に固定されるとともに、それぞれの第3の半導体チップ26の複数の金パンプ1d(図16参照)と、図14(a)に示す多数個取り基板7のデバイス領域7aの複数の第2接続端子3fとが電気的に接続される。

【0135】これによって、図23(a)、(b)に示すように、多数個取り基板7上に搭載される下層側の半導体チップである第1の半導体チップ1および第3の半導体チップ26のマウントを完了する。

【0136】なお、第1NCF12bおよび第2NCF12cは、熱硬化性樹脂によって形成されたフィルムである。したがって、熱圧着ヘッド20およびダイボンドステージ21による荷重と熱とで第1NCF12bおよび第2NCF12cの熱硬化性樹脂が熱硬化し、これによって熱圧着が行われる。

【0137】また、本実施の形態2では、図17に示すように、まず、ある複数(ここでは千鳥配列の場合を説明したが、千鳥配列以外の複数であってもよい)の第1NCF12bの配置を行い、さらに、図21に示すよう

に、この第1NCF12b上へ複数の第1の半導体チップ1よりなる第1の半導体チップ群の搭載を済ませた後、図22に示すように、残りの第2NCF12cを配置してこれの上に、図23に示すように複数の第3の半導体チップ26よりなる第2の半導体チップ群の搭載を行って複数の第1の半導体チップ1と複数の第3の半導体チップ26すなわち下層側の半導体チップの実装を完了する場合を説明した。

【0138】しかしながら、熱圧着ヘッド20による隣接するデバイス領域7aへの熱影響が無視できる場合には、先に、NCF12の配置を全数完成させ、その後、まとめて複数の第1の半導体チップ1および複数の第3の半導体チップ26の熱圧着によるダイボンド（マウント）を行っても良く、この場合には、NCF12を第1NCF12bと第2NCF12cとに分ける必要がなく、かつ、第1の半導体チップ1の搭載についても、1つの工程で行うことができるため、NCF12の実装と下層側の半導体チップの搭載とを効率良く行うことが可能になる。

【0139】また、逆に、熱圧着ヘッド20による隣接するデバイス領域7aへの熱影響が非常に大きく、例えば、対角線方向に隣接するデバイス領域7a同士での熱影響さえ無視できない場合には、全ての隣接するデバイス領域7aには同時にNCF12を配置しないように、全体の数分の4分の1ずつNCF12を配置し、4回に分けて第1の半導体チップ1を実装するようにしてもよい。

【0140】次に、図11のステップS4に示す第2の半導体チップ2の搭載を行う。

【0141】なお、本実施の形態2は、図24に示すように、第1の半導体チップ1の全数実装後に第2の半導体チップ2を搭載する場合である。

【0142】ただし、個々の第2の半導体チップ2の搭載については、実施の形態1で説明した第2の半導体チップ2の搭載方法と同じである。

【0143】すなわち、第1の半導体チップ1の裏面1c上に第1の半導体チップ1よりは厚さが薄く形成された第2の半導体チップ2を、第1の半導体チップ1の裏面1cと第2の半導体チップ2の裏面2cとがダイボンドフィルム材5（図6（a）参照）を介して向かい合うように配置するとともに、図5（b）に示す熱圧着ヘッド20によって第1の半導体チップ1のダイボンドの際に付与した圧力（CSP22が200バンプの場合、10～20kgf程度の荷重）より小さな圧力を加えつつ配置する。

【0144】これにより、フリップチップ接続された第1の半導体チップ1の裏面1cに、熱と荷重とによってダイボンドフィルム材5を接着材として第2の半導体チップ2を固着する（図26（a）参照）。

【0145】なお、その際の荷重（圧力）は、CSP9

の第2の半導体チップ2の主面2bの大きさが、例えば、50mm²程度の場合、1kgf程度で、かつ、温度は160℃程度である。

【0146】この方法で、順次複数の第2の半導体チップ2および複数の第4の半導体チップ27の熱圧着を行っていき、第2の半導体チップ2と第4の半導体チップ27の実装を、図24に示すように全数完了させる。

【0147】なお、ここでの複数の第4の半導体チップ27は、第2の半導体チップ2と同じ構造で、かつ前記複数の第3の半導体チップ26の上にそれぞれ配置されるものである。

【0148】その後、図11のステップS5に示す第2の半導体チップ2および第4の半導体チップ27の複数のパッド2aと、それぞれに対応するデバイス領域7aである個片基板3の複数の第1接続端子3eまたは第2接続端子3fとをワイヤボンディングによる金線のワイヤ4を介して電気的に接続する（図25（b）、図26（b）参照）。

【0149】このワイヤボンディングを、図25（a）に示すように、順次第2の半導体チップ2に対して行っていく、第4の半導体チップ27を含む第2の半導体チップ2のワイヤボンディングを全数完了させる。

【0150】その後、図11のステップS6に示す第1の半導体チップ1（第3の半導体チップ26を含む）、第2の半導体チップ2（第4の半導体チップ27を含む）および複数のワイヤ4の樹脂封止である樹脂モールドを行う。

【0151】ここでは、多数個取り基板7における複数のデバイス領域7aを1つのキャビティ13aで覆って一括にモールドし、その後、ダイシングを行って個片化する一括モールド：MAP（Mold Array Package）方式の場合を説明する。

【0152】まず、モールド工程では、図29（a）、（b）に示すように、互いに向かい合う第1の側面13bおよび第2の側面13cと、第1の側面13bおよび第2の側面13cと接しており、かつ互いに向かい合う第3の側面13dおよび第4の側面13e、さらに、前記第1～第4の側面13eに隣接する上面13jおよび下面13kを有するキャビティ13a、および第1の側面13b上に形成された複数の樹脂注入口13fを持つ金型であるモールド金型13を準備する。

【0153】すなわち、モールド金型13は、上型13hと下型13iとからなり、第1の側面13bと第2の側面13cと第3の側面13dと第4の側面13eおよび上面13jとを有するキャビティ13aがモールド金型13の上型13hに形成されている。

【0154】さらに、モールド金型13の上型13hには、第2の側面13c上にベントホールとして空気孔13gが形成されている。

【0155】一方、複数のデバイス領域7aが形成され

10

20

30

40

50

た配線基板である多数個取り基板7と、多数個取り基板7の複数のデバイス領域7aのそれぞれに固定された第1の半導体チップ1と、第1の半導体チップ1上に固定された第2の半導体チップ2とを準備する。

【0156】すなわち、図27(a)に示すように、ワイヤボンディング後の多数個取り基板7を準備する。

【0157】なお、多数個取り基板7の長手方向の一方(モールド金型13の樹脂注入口13fに対応する側)の端部には複数の金メッキ部7cが形成されている。これは、モールドによって形成される図27(b)に示す樹脂ゲート部8aの多数個取り基板7からの剥離を容易にするためのものである。

【0158】その後、図29(a)に示すように、多数個取り基板7、複数の第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2をキャビティ13aの内部で下型13iに配置して図29(b)に示すように複数のデバイス領域7aを上型13hのキャビティ13aによって一括で覆う。

【0159】なお、キャビティ13a内において、キャビティ13aの第3の側面13dと平行な断面(図29(a)の断面のこと)において、それぞれの第1の半導体チップ1の長さが、第1の半導体チップ1に積層された第2の半導体チップ2の長さよりも長くなるように複数の第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2を配置する。

【0160】これに対して90°方向を変えた断面、すなわちキャビティ13aの第1の側面13bと平行な断面(図29(b)のこと)においては、第1の半導体チップ1の長さが、第2の半導体チップ2の長さよりも短くなるように、第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2を配置する。

【0161】すなわち、第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2の関係を、図28に示す樹脂流入方向に対して、第1の半導体チップ1の長さが、第2の半導体チップ2の長さよりも長くなるような関係とする。

【0162】この時、樹脂流入方向に対して直角をなす方向では、第1の半導体チップ1の長さが、第2の半導体チップ2の長さよりも短くなるような関係である。

【0163】この状態で上型13hと下型13iとの型締めを行った後、それぞれのデバイス領域7aに対応した複数の樹脂注入口13fより樹脂(レジン)を注入して、複数の第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2を一括で樹脂封止する。

【0164】この場合、図28に示す樹脂流入方向に対して、第1の半導体チップ1の裏面1cと第2の半導体チップ2との間に段差が生じ、上層側の第2の半導体チップ2の方が引っ込んでいるため、図29(a)に示すようなレジンの流れ23となり、第2の半導体チップ2の主面2b上に樹脂(レジン)が容易に回り込み、キャビティ13a内の空気を空気孔13gから追い出すこと

ができる。

【0165】したがって、第2の半導体チップ2の主面2b上でのボイドの発生を抑えることができ、モールド性を向上できる。

【0166】また、図29の変形例として、キャビティ13a内において樹脂流入方向に平行な方向に対して、図30および図31(a)に示すように、第2の半導体チップ2が、第1の半導体チップ1の外周より平面的に突出する部分を有するように、両者を配置してもよく、その場合、第2の半導体チップ2の突出する部分と多数個取り基板7のチップ支持面3aとの間を接着材であるNCF12によって充填する。

【0167】この状態で上型13hと下型13iとの型締めを行った後、それぞれのデバイス領域7aに対応した複数の樹脂注入口13fより樹脂(レジン)を注入して、複数の第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2を一括で樹脂封止する。

【0168】仮に、第2の半導体チップ2の突出する部分と多数個取り基板7のチップ支持面3aとの間がNCF12によって充填されていない場合には、キャビティ13aの第1の側面13bから遠い側の第2の半導体チップ2が突出する部分の下に、樹脂の未充填部分(ボイド)が発生する可能性が高くなる。トランスファーモールド法においては、モールド工程の最終段階に樹脂に非常に圧力をかけて、樹脂中のボイドを排除または圧縮することでボイドの体積を減らすことが可能であるが、前記のようにチップの下に大きなボイドがある状態で樹脂に圧力をかけると、チップが割れる恐れがある。

【0169】しかし、本実施の形態2においては、第2の半導体チップ2の突出する部分と多数個取り基板7のチップ支持面3aとの間は、モールド工程前に予めNCF12によって充填されているので、トランスファーモールド工程時に圧力をかけたとしてもチップが割れる問題を回避することができる。

【0170】モールドを終了すると、多数個取り基板7上に、図27(b)、図32に示すような一括モールド部8と複数の樹脂ゲート部8aとが形成される。

【0171】その後、図11のステップS7のはんだボール搭載を行って多数個取り基板7のデバイス領域7aのバンプランド3dにはんだボールの仮止めを行う。

【0172】続いて、ステップS8の前記のはんだボールのリフローを行って、前記のはんだボールのバンプランド3dへの固定を行う。

【0173】その後、ステップS9の多数個取り基板7のダイシングを行って個々のパッケージに個片化する。

【0174】さらに、ステップS10のマーク捺印およびステップS11の電気試験を行ってCSP22の組み立てを完了する。

【0175】(実施の形態3) 図35は本発明の実施の形態3の半導体装置(スタック構造のCSP)の構造の

一例を樹脂封止体を透過して示す平面図、図36は図35に示すJ-J線に沿って切断した断面の構造を示す拡大断面図、図37は図35に示すCSPに組み込まれる第1の半導体チップの構造の一例を示す平面図、図38は図35に示すCSPの組み立ての第1の半導体チップのマウント状態の一例を示す拡大断面図、図39は図35に示すCSPの組み立ての第1の半導体チップの熱圧着状態の一例を示す拡大断面図、図40は図39に示す熱圧着工程における熱圧着後の接着材の形状の一例を示す拡大断面図、図41は図35に示すCSPの組み立ての第2および第3の半導体チップのマウント状態の一例を示す拡大断面図、図42は図35に示すCSPの組み立てのワイヤボンディング状態の一例を示す拡大断面図、図43は図35に示すCSPの変形例の組み立ての第1の半導体チップと第2の半導体チップの接着方法の一例を示す拡大断面図、図44は図35に示すCSPの変形例の組み立ての第1の半導体チップへの突起電極の形成方法の一例を示す拡大断面図、図45は図35に示すCSPの変形例の組み立ての第1の半導体チップの配線基板への接着方法の一例を示す拡大断面図、図46は図35に示すCSPの変形例の組み立ての第1および第2の半導体チップの熱圧着状態の一例を示す拡大断面図、図47は図35に示すCSPの変形例の組み立ての第3の半導体チップの熱圧着状態の一例を示す拡大断面図である。

【0176】図35に示す本実施の形態3の半導体装置は、個片基板3（配線基板）上に3つの半導体チップが積層されたスタック構造のものであるとともに、個片基板3のチップ支持面3a（主面）側において第1の半導体チップ1と、第1の半導体チップ1上に積層された第2の半導体チップ2と、第2の半導体チップ2上に積層された第3の半導体チップ29とが樹脂モールドによって封止された樹脂封止形のものであり、チップ3層のスタック構造のCSP30である。

【0177】CSP30の構造の特徴は、図35および図36に示すように、3段めの半導体チップである第3の半導体チップ29の主面29bに形成された電極である複数のパッド29aが、第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2のそれぞれの端部より外側の位置に配置されていることであり、その際、第2の半導体チップ2の第1の半導体チップ1からはみ出した箇所の裏面2cと、第3の半導体チップ29の第2の半導体チップ2からはみ出した箇所の裏面29cにも接着材であるNCF12が配置されていることである。

【0178】すなわち、CSP30は、第3の半導体チップ29の各パッド29aの下側にもNCF12が配置されている構造の半導体パッケージである。

【0179】したがって、第3の半導体チップ29の主面29bの各パッド29aに対応した裏面29c側の領域をNCF12で支えることが可能なため、第3の半導

体チップ29に対してもワイヤボンディングを行うことができる、第3の半導体チップ29のパッド29aも、第2の半導体チップ2と同様にワイヤ4と接続されている。

【0180】そこで、接着材であるNCF12は、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとの間に形成された第1の部分である第1チップ接合部12dと、第1の半導体チップ1を配置する領域の外側であり、かつ第2の半導体チップ2の裏面2cと個片基板3のチップ支持面3aの間に形成された第2の部分であるはみ出し部12eと、第1の半導体チップ1を配置する領域および第2の半導体チップ2を配置する領域の外側であり、かつ第3の半導体チップ29の裏面29cと個片基板3のチップ支持面3aとの間に形成された第3の部分であるはみ出し部12fとを有している。

【0181】したがって、NCF12は、そのはみ出し部12eが、第1チップ接合部12dよりも厚く、さらに、はみ出し部12fが、はみ出し部12eよりも厚く形成されている。

【0182】なお、接着材としては、NCF12やACFなどが好ましいが、NCF12やACF以外のものであってもよい。

【0183】また、第2の半導体チップ2と第3の半導体チップ29は、それぞれ第1の半導体チップ1の裏面1cと、第2の半導体チップ2の主面2bにダイボンドフィルム材5によって接着されている。

【0184】なお、NCF12やダイボンドフィルム材5などの接着材は、熱硬化性のものであり、熱硬化性樹脂を含んでいる。

【0185】ここで、CSP30におけるそれぞれの半導体チップは、例えば、第1の半導体チップ1がマイコンであり、第2の半導体チップ2がSRAM(Static Random Access Memory)であり、第3の半導体チップ29がFlashメモリなどであるが、それぞれの半導体チップの機能については、前記した機能に限定されことなく、他の機能のものであってもよい。

【0186】本実施の形態3のCSP30のその他の構造については、実施の形態1のCSP9と同様であるため、その重複説明は省略する。

【0187】次に、本実施の形態3のCSP30の製造方法について説明する。

【0188】まず、チップ支持面3aおよびその反対側の裏面3bを有するとともに、チップ支持面3a上に複数の接続端子（電極）3cを有する個片基板3（配線基板）を準備する。

【0189】さらに、第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2と第3の半導体チップ29を準備する。

【0190】すなわち、主面1bおよび裏面1cを有し、かつ主面1b上に複数のパッド1aおよび複数の半

10

20

30

40

50

導体素子を有する第1の半導体チップと、同様に、主面2bおよび裏面2cを有し、かつ主面2b上に複数のパッド2aおよび複数の半導体素子を有する第2の半導体チップ2と、同様に、主面29bおよび裏面29cを有し、かつ主面29b上に複数のパッド29aおよび複数の半導体素子を有する第3の半導体チップ29を準備する。

【0191】その際、第1の半導体チップ1の各パッド1a上には突起電極である金バンプ1dが形成されている。

【0192】なお、CSP30に搭載される第1の半導体チップ1は、図37に示すように、正方形で、かつその主面1bの外周部に複数のパッド1aが並んで配置された外周パッド配列のものである。

【0193】その後、図38～図40に示す第1の半導体チップ1のマウントを行う。

【0194】まず、図38に示すように第1の半導体チップ1の主面1bを個片基板3のチップ支持面3aに向かい合わせ、第1の半導体チップ1の複数のパッド1aが個片基板3の複数の接続端子3cと対向するように第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に配置する。

【0195】その後、第1の半導体チップ1の裏面1cに圧力を加えて第1の半導体チップ1の複数のパッド1aと個片基板3の複数の接続端子3cとを電気的に接続する。

【0196】その際、まず、個片基板3のチップ支持面3aの第1の半導体チップ1搭載エリアに第1の半導体チップ1より大きめに切断したNCF12（接着材）を配置し、続いて、第1の半導体チップ1のパッド1aが個片基板3の接続端子3cと対向するように、かつパッド1aとこれに対応する接続端子3cとを位置決めして第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に配置し、その後、第1の半導体チップ1の裏面1cに荷重を印加する。

【0197】これにより、金バンプ1dがNCF12に突きささり、第1の半導体チップ1が個片基板3上に仮固定される。

【0198】その後、図39に示すような先端に突起部28aを有する熱圧着用治具である熱圧着ヘッド28によって、第1の半導体チップ1の裏面1cに圧力を加える。また、前記圧力と同時に熱圧着ヘッド28から熱も加える。

【0199】これによって、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとの間でNCF12の熱硬化性樹脂を硬化させ、前記熱硬化性樹脂を介して第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に固定する。

【0200】なお、熱圧着ヘッド28の先端の突起部28aは、第1の半導体チップ1上に搭載する第2の半導

体チップ2と略同じ形状で、かつ略同じ大きさに形成されている。具体的には、突起部28aの平面方向（加圧方向と直角の方向）の大きさは、第2の半導体チップ2より僅かに大きく、かつ突起部28aの突出分の高さは、第2の半導体チップ2の厚さより僅かに小さく形成されている。

【0201】さらに、NCF12は、第1の半導体チップ1が加圧・加熱された際に、この圧力によって第1の半導体チップ1の外側周囲にはみ出すとともに、はみ出し部12eとはみ出し部12fを形成するための所望の厚さを有しているものである。

【0202】したがって、熱圧着ヘッド28によって第1の半導体チップ1の裏面1cを加圧すると、NCF12が第1の半導体チップ1の外側周囲にはみ出すとともに、熱圧着ヘッド28の突起部28aに応じた形状のはみ出し部（第2の部分）12eと、はみ出し部（第3の部分）12fが形成される。

【0203】これにより、NCF12では、図40に示すように、第1チップ接合部12dと、これより厚いのはみ出し部12eと、さらに、はみ出し部12eより厚いのはみ出し部12fとが形成される。

【0204】なお、はみ出し部12fとはみ出し部12eの厚さの差は、熱圧着ヘッド28の突起部28aの高さが第2の半導体チップ2の厚さより僅かに小さく形成されているため、第2の半導体チップ2の厚さより小さくなる。

【0205】また、熱圧着では、個片基板3を70℃前後に加熱されたダイボンドステージ21上に載置し、第1の半導体チップ1の裏面1cを300℃前後に加熱された熱圧着ヘッド28で加圧する。

【0206】その結果、NCF12が高温となり、溶融・硬化することにより、第1の半導体チップ1のパッド1a上の金バンプ1dと、個片基板3の接続端子3cとが接触して電気的に導通する。

【0207】その後、図41に示す第2の半導体チップ2および第3の半導体チップ29のマウントを行う。

【0208】なお、第2の半導体チップ2と第3の半導体チップ29は、予め両者を接着しておく。

【0209】すなわち、予め第3の半導体チップ29の裏面29cに貼り付けられたダイボンドフィルム材5によって第2の半導体チップ2の主面2bと第3の半導体チップ29の裏面29cとが接着されている。

【0210】その際、第3の半導体チップ29の複数のパッド29aが、第2の半導体チップ2より外側に配置されるように第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2を接着する。なお、第2の半導体チップ2の裏面2cにも、同様のダイボンドフィルム材5が貼り付けられている。

【0211】このように、第2の半導体チップ2と第3の半導体チップ29とが接着された状態で、第2の半導

10

20

30

40

50

体チップ2の裏面2cが第1の半導体チップ1の裏面1cと向かい合うように第1の半導体チップ1上に第2の半導体チップ2および第3の半導体チップ29を配置する。

【0212】これにより、第3の半導体チップ29の複数のパッド29aは、第1の半導体チップ1より外側に位置し、かつ第2の半導体チップ2より外側に配置された状態となる。

【0213】その後、第3の半導体チップ29の上方からその主面29bに対して荷重および熱を印加して、第2の半導体チップ2および第3の半導体チップ29の熱圧着を行う。

【0214】その際、第2の半導体チップ2の裏面2cおよび第3の半導体チップ29の裏面29cにそれぞれ貼り付けられたダイボンドフィルム材5が接着材となって第2の半導体チップ2および第3の半導体チップ29が熱圧着される。

【0215】なお、NCF12におけるはみ出し部12fとはみ出し部12eの厚さの差が第2の半導体チップ2の厚さより僅かに小さいため、NCF12の一部すなわちはみ出し部12fは、第1の半導体チップ1の外側に配置された第3の半導体チップ29の複数のパッド29aと、個片基板3のチップ支持面3aとの間における第3の半導体チップ29の裏面29cとはみ出し部12fとの間隔（隙間）が、第3の半導体チップ29の厚さよりも小さくなるように配置された状態となる。

【0216】つまり、NCF12のはみ出し部12fと第3の半導体チップ29の裏面29cとの間に形成される隙間は、第3の半導体チップ29の厚さよりも遥かに小さいものである。

【0217】第2の半導体チップ2および第3の半導体チップ29のマウント完了により、第3の半導体チップ29の各パッド29aが、第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2の外側に配置された状態となる。

【0218】その後、ワイヤボンディングを行う。

【0219】すなわち、図42に示すように、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aおよび第3の半導体チップ29の複数のパッド29aとそれぞれに対応する個片基板3の複数の接続端子3cとをワイヤボンディングによる金線のワイヤ4を介して電氣的に接続する。

【0220】その際、まず、第2の半導体チップ2からワイヤボンディングを行う。第2の半導体チップ2のワイヤボンディングでは、第1の半導体チップ1より外側に配置された第2の半導体チップ2のパッド2aに対して、その裏面2c側に配置されたNCF12のはみ出し部12eがワイヤボンディング時の荷重受けとなるため、ワイヤボンディング時の第2の半導体チップ2の割れを防止することができる。

【0221】第2の半導体チップ2に対してのワイヤボンディングを終えた後、第3の半導体チップ29に対し

てのワイヤボンディングを行う。

【0222】第3の半導体チップ29のワイヤボンディングでは、第2の半導体チップ2より外側に配置された第3の半導体チップ29の各パッド29aに対して、その裏面29c側に配置されたNCF12のはみ出し部12fがワイヤボンディング時の荷重受けとなるため、ワイヤボンディング時の第3の半導体チップ29の割れを防止することができる。

【0223】ここでは、はみ出し部12fと第3の半導体チップ29の裏面29cとの間に形成される隙間は、第3の半導体チップ29の厚さよりも遥かに小さく、はみ出し部12fがワイヤボンディング時の荷重を確実に受けることができるため、第3の半導体チップ29の割れを防ぐことができる。

【0224】その後、第1の半導体チップ1、第2の半導体チップ2、第3の半導体チップ29および複数のワイヤ4を樹脂封止する。

【0225】すなわち、個片基板3のチップ支持面3a側において、トランスファーモルディングによって第1の半導体チップ1、第2の半導体チップ2、第3の半導体チップ29および複数のワイヤ4を樹脂封止して樹脂封止体6を形成する。

【0226】なお、樹脂モルディング時においても、金型クランプ時などの荷重が第3の半導体チップ29に印加された際にも、NCF12のはみ出し部12fが荷重受けとなるため、第3の半導体チップ29の割れを防ぐことができる。

【0227】その後、図36に示すように、個片基板3の裏面3b上に、個片基板3の複数の接続端子3cと電氣的に接続する複数の突起電極である半田ボール11を搭載する。

【0228】すなわち、個片基板3の裏面3bに露出する各バンプランド3d（図14参照）に、半田ボール11をリフローなどによって搭載してCSP30の外部電極を形成する。

【0229】次に、本実施の形態3のCSP30の製造方法の変形例について説明する。

【0230】まず、図43に示すように、第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2を接着する。ここでは、第1の半導体チップ1の裏面1cと第2の半導体チップ2の裏面2cとを向き合わせて配置して接着する。その際、予め第1の半導体チップ1の裏面1cにダイボンドフィルム材5を貼り付けておき、両者を熱圧着用治具である熱圧着ヘッド33を用いた熱圧着によってダイボンドフィルム材5を介して接着する。

【0231】その後、図44に示すように、第1の半導体チップ1の各パッド1a上に突起電極である図45に示すような金バンプ1dを形成する。

【0232】その際、金線を用いたワイヤボンディング技術を利用して第1の半導体チップ1のパッド1aに金

10

20

30

40

50

パンプ1dを形成する。つまり、ボンディングツールであるキャピラリ32によってワイヤ4を案内し、ワイヤボンディングと同様にして第1の半導体チップ1のパッド1a上に金パンプ1dを形成する。

【0233】その後、個片基板3のチップ支持面3aの第1の半導体チップ1搭載エリアに第1の半導体チップ1より大きめに切断したNCF12を配置し、続いて、第1の半導体チップ1のパッド1aが個片基板3の接続端子3cと対向するように、かつパッド1aとこれに対応する接続端子3cとを位置決めして第1の半導体チップ1および第2の半導体チップ2を個片基板3のチップ支持面3a上に配置する。

【0234】すなわち、個片基板3のチップ支持面3a上に、第2の半導体チップ2と接着された第1の半導体チップ1を、その主面1bが個片基板3のチップ支持面3aに向き合うように配置する。

【0235】その後、熱圧着ヘッド33を用いて熱圧着を行い、複数の金パンプ1dを介して第1の半導体チップ1と個片基板3の複数の接続端子3cとを電気的に接続するとともに、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとの間をNCF12で接着する。

【0236】その際、図45に示すように、第2の半導体チップ2の主面2b側から熱圧着ヘッド33によって第2の半導体チップ2を介して荷重と熱を印加する。

【0237】これによって、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとの間でNCF12の熱硬化性樹脂を硬化させ、前記熱硬化性樹脂を介して第1の半導体チップ1が個片基板3のチップ支持面3a上に固定され、さらに、第1の半導体チップ1のパッド1a上の金パンプ1dと個片基板3の接続端子3cとが接触して電気的に導通する。

【0238】なお、NCF12は、第1の半導体チップ1が加圧・加熱された際に、この圧力によって第1の半導体チップ1の外側周囲にはみ出すとともに、はみ出し部12eおよびはみ出し部12fを形成するための所望の厚さを有しているものである。

【0239】したがって、図46に示すように、熱圧着ヘッド33によって第2の半導体チップ2を介して第1の半導体チップ1を加圧すると、NCF12が第1の半導体チップ1の外側周囲にはみ出すとともに、第2の半導体チップ2の第1の半導体チップ1より突出した裏面2c側にはみ出し部（第2の部分）12eが形成され、さらにその外側に、はみ出し部（第3の部分）12fが形成される。

【0240】その際、熱圧着ヘッド33の加圧面により、第2の半導体チップ2の主面2bとはみ出し部12fとは、ほぼ同一の高さ、または僅かにはみ出し部12fの方が低く形成される。

【0241】その後、第2の半導体チップ2の主面2b

上に、第3の半導体チップ29をその裏面29cが第2の半導体チップ2の主面2bに向き合うように接着する。

【0242】その際、第3の半導体チップ29の複数のパッド29aが、第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2より外側の位置に配置されるように第3の半導体チップ29を第2の半導体チップ2上に配置する。

【0243】すなわち、第3の半導体チップ29の複数のパッド29aが、第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2より外側に配置されるとともに、予めダイボンドフィルム材5が裏面29cに貼り付けられた第3の半導体チップ29をその裏面29cを第2の半導体チップ2の主面2bに向けてこの主面2b上に配置し、その後、図47に示すように、第3の半導体チップ29の上方から熱圧着ヘッド33により第3の半導体チップ29の主面29bに対して加圧・加熱を行って両者を接着する。

【0244】これにより、第2の半導体チップ2は、第1の半導体チップ1の裏面1c上に熱硬化性樹脂を含むダイボンドフィルム材5を介して接着されるとともに、第3の半導体チップ29は、第2の半導体チップ2の主面2b上に、同様に熱硬化性樹脂を含むダイボンドフィルム材5を介して接着された状態となり、その際、第3の半導体チップ29の複数のパッド29aは、第1の半導体チップ1と第2の半導体チップ2の外側の位置に配置されている。

【0245】その後、前記した図42に示すワイヤボンディングと同様の方法でワイヤボンディングを行う。

【0246】その際、第1の半導体チップ1より外側に配置された第2の半導体チップ2のパッド2aに対して、その裏面2c側に配置されたNCF12のはみ出し部12eがワイヤボンディング時の荷重受けとなるため、ワイヤボンディング時の第2の半導体チップ2の割れを防止することができる。

【0247】さらに、第2の半導体チップ2より外側に配置された第3の半導体チップ29の各パッド29aに対して、その裏面29c側に配置されたNCF12のはみ出し部12fがワイヤボンディング時の荷重受けとなるため、ワイヤボンディング時の第3の半導体チップ29の割れを防止することができる。

【0248】また、前記変形例の製造方法では、熱圧着ヘッド33の先端（加圧面）の形状を平坦な面にすることができ、前記した本実施の形態3の一例の熱圧着ヘッド28と比較してその形状を簡単な形状にすることができる。

【0249】なお、ワイヤボンディング後の製造方法とそれによって得られるその他の効果については、前記した本実施の形態3の一例と同様であるため、その重複説明は省略する。

【0250】（実施の形態4）図48は本発明の実施の

10

20

30

40

50

形態4の半導体装置(スタック構造のCSP)の構造の一例を樹脂封止体を透過して示す平面図、図49は図48に示すCSPに組み込まれる第1の半導体チップの構造の一例を示す平面図、図50は図48に示すCSPの組み立てにおける第1の半導体チップのマウント状態の一例をK-K線に沿って切断した箇所を示す拡大断面図、図51は図48に示すCSPの組み立てにおける第2の半導体チップのマウント状態の一例を示す拡大断面図、図52は図48に示すCSPの組み立てにおける第3の半導体チップのマウント状態の一例を示す拡大断面図、図53は図48に示すCSPの組み立てにおけるワイヤボンディング状態の一例を示す拡大断面図、図54は図48に示すCSPのK-K線に沿って切断した断面の構造を示す拡大断面図である。

【0251】本実施の形態4の半導体装置は、実施の形態3のCSP30と同様に、個片基板3上に3つの半導体チップが積層されたスタック構造のCSP31(図48参照)であるが、実施の形態3のCSP30との構造の相違点は、3段めの半導体チップである第3の半導体チップ29の複数のパッド29aが、2段めの第2の半導体チップ2の端部より内側の領域で、かつ1段めの第1の半導体チップ1より外側の位置に配置されていることである。

【0252】したがって、接着材であるNCF12は、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとの間に形成された第1の部分である第1チップ接合部12dと、第1の半導体チップ1を配置する領域の外側であり、かつ第2の半導体チップ2の裏面2cと個片基板3のチップ支持面3aの間に形成された第2の部分であるはみ出し部12eとを有しており、第3の半導体チップ29の各パッド29aは、第2の半導体チップ2上に配置されているため、はみ出し部12eは、第2の半導体チップ2の各パッド29aの裏面2c側と第3の半導体チップ29の各パッド29aの裏面29c側とに配置されていることになる。

【0253】これにより、CSP31におけるNCF12のはみ出し部12eは、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aが配置された領域を支持するとともに、さらにこの第2の半導体チップ2を介して第3の半導体チップ29の複数のパッド29aが配置された領域も支持している。

【0254】また、CSP31に搭載されている第1の半導体チップ1は、図49に示すように、長方形で、かつその主面1bの幅方向の中央付近に複数のパッド1aが長手方向に平行に並んで配置されたセンタパッド配列のものである。

【0255】また、CSP31におけるそれぞれの半導体チップは、例えば、第1の半導体チップ1がDRAM(Dynamic Random Access Memory)であり、第2の半導体チップ2がSRAM(Static Random Access Memory)

であり、第3の半導体チップ29がFlashメモリなどであるが、それぞれの半導体チップの機能については、前記した機能に限定されることなく、他の機能のものであってもよい。

【0256】本実施の形態4のCSP31のその他の構造については、実施の形態3のCSP30と同様であるため、その重複説明は省略する。

【0257】次に、本実施の形態4のCSP31の製造方法について説明する。

【0258】まず、実施の形態3と同様に、複数の接続端子3cを有する個片基板3、第1の半導体チップ1、第2の半導体チップ2および第3の半導体チップ29を準備する。

【0259】なお、第1の半導体チップ1は、図49に示すようなセンタパッド配列のものであり、各パッド1a上には、実施の形態3と同様に突起電極である金パンプ1dが形成されている。

【0260】その後、図50に示す第1の半導体チップ1のマウントを行う。

【0261】まず、第1の半導体チップ1の主面1bを個片基板3のチップ支持面3aに向かい合わせ、第1の半導体チップ1の複数のパッド1aが個片基板3の複数の接続端子3cと対向するように第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に配置する。

【0262】その後、第1の半導体チップ1の裏面1cに圧力を加えて第1の半導体チップ1の複数のパッド1aと個片基板3の複数の接続端子3cとを電氣的に接続する。

【0263】その際、まず、個片基板3のチップ支持面3aの第1の半導体チップ1搭載エリアに第1の半導体チップ1より大きめに切断したNCF12を配置し、続いて、第1の半導体チップ1のパッド1aが個片基板3の接続端子3cと対向するように、かつパッド1aとこれに対応する接続端子3cとを位置決めして第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に配置し、その後、第1の半導体チップ1の裏面1cに荷重を印加する。

【0264】これにより、金パンプ1dがNCF12に突きささり、第1の半導体チップ1が個片基板3上に仮固定される。

【0265】その後、加圧面が平坦な熱圧着ヘッド33によって、第1の半導体チップ1の裏面1cに圧力を加え、これと同時に熱圧着ヘッド33から熱も加える。

【0266】これによって、第1の半導体チップ1の主面1bと個片基板3のチップ支持面3aとの間でNCF12の熱硬化性樹脂を硬化させ、前記熱硬化性樹脂を介して第1の半導体チップ1を個片基板3のチップ支持面3a上に固定する。その結果、第1の半導体チップ1のパッド1a上の金パンプ1dと、個片基板3の接続端子3cとが接触して電氣的に導通する。

【0267】なお、NCF12は、第1の半導体チップ1が加圧・加熱された際に、この圧力によって第1の半導体チップ1の外側周囲にはみ出すが、熱圧着ヘッド33の加圧面によって覆われているため、はみ出し部12eが形成される。

【0268】これにより、第1の半導体チップ1の裏面1cとはみ出し部12eとがほぼ同一の高さ、または、はみ出し部12eの方が僅かに低く形成される。

【0269】その後、図51に示す第2の半導体チップ2のマウントを行う。

【0270】ここでは、第1の半導体チップ1の裏面1c上に、第2の半導体チップ2をその裏面2cが第1の半導体チップ1の裏面1cに向き合うように接着する。

【0271】その際、図48に示すように、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aが、第1の半導体チップ1より外側の位置に配置されるように第2の半導体チップ2を第1の半導体チップ1上に配置する。

【0272】すなわち、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aが、第1の半導体チップ1より外側に位置して、かつNCF12のはみ出し部12e上に配置されるとともに、予めダイボンドフィルム材5が裏面2cに貼り付けられた第2の半導体チップ2をその裏面2cを第1の半導体チップ1の裏面1cに向けてこの裏面1c上に配置し、その後、第2の半導体チップ2の上方から熱圧着ヘッド33によって第2の半導体チップ2の主面2bに対して加圧・加熱を行って両者を接着する。

【0273】これにより、第2の半導体チップ2は、第1の半導体チップ1の裏面1c上に熱硬化性樹脂を含むダイボンドフィルム材5を介して接着された状態となり、その際、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aは、第1の半導体チップ1の外側の位置に配置されている。

【0274】その後、図52に示す第3の半導体チップ29のマウントを行う。

【0275】ここでは、第2の半導体チップ2の主面2b上に、第3の半導体チップ29をその裏面29cが第2の半導体チップ2の主面2bに向き合うように接着する。その際、第3の半導体チップ29の複数のパッド29aが、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aが配置されている領域より内側で、かつ第1の半導体チップ1より外側に配置されるように第3の半導体チップ29を第2の半導体チップ2上に配置する。

【0276】その後、第3の半導体チップ29の上方から熱圧着ヘッド33により第3の半導体チップ29の主面29bに対して加圧・加熱を行って両者を接着する。

【0277】これにより、第3の半導体チップ29は、第2の半導体チップ2の主面2b上に、熱硬化性樹脂を含むダイボンドフィルム材5を介して接着された状態となり、その際、第3の半導体チップ29の複数のパッド29aは、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aが

配置されている領域より内側で、かつ第1の半導体チップ1より外側に配置された状態となる。

【0278】したがって、第2の半導体チップ2の第1の半導体チップ1より突出した領域がNCF12のはみ出し部12eによって支持されるとともに、第3の半導体チップ29の複数のパッド29aが配置された領域が第2の半導体チップ2を介して同じくはみ出し部12eによって支持された状態となる。

【0279】その後、図53に示すようにワイヤボンディングを行う。

【0280】すなわち、第2の半導体チップ2の複数のパッド2aおよび第3の半導体チップ29の複数のパッド29aとそれぞれに対応する個片基板3の複数の接続端子3cとをワイヤボンディングによって電気的に接続する。

【0281】その際、まず、第2の半導体チップ2からワイヤボンディングを行う。

【0282】なお、NCF12の一部すなわちはみ出し部12eは、第1の半導体チップ1の外側に配置された第2の半導体チップ2の複数のパッド2aが配置された領域の裏面2cとはみ出し部12eとの間隔（隙間）が、第2の半導体チップ2の厚さよりも小さくなるように配置された状態である。

【0283】したがって、第2の半導体チップ2のワイヤボンディングでは、第1の半導体チップ1より外側に配置された第2の半導体チップ2の複数のパッド2aそれぞれに対して、その裏面2c側に配置されたNCF12のはみ出し部12eがワイヤボンディング時の荷重受けとなるため、ワイヤボンディング時の第2の半導体チップ2の割れを防止することができる。

【0284】第2の半導体チップ2に対してのワイヤボンディングを終えた後、第3の半導体チップ29に対してのワイヤボンディングを行う。第3の半導体チップ29のワイヤボンディングでは、第2の半導体チップ2とその裏面2c側に配置されたNCF12のはみ出し部12eとがワイヤボンディング時の荷重受けとなるため、ワイヤボンディング時の第3の半導体チップ29の割れを防止することができる。

【0285】その後、第1の半導体チップ1、第2の半導体チップ2、第3の半導体チップ29および複数のワイヤ4をトランスファーモルディングによって樹脂封止し、これによって図54に示すような樹脂封止体6を形成する。

【0286】なお、樹脂モルディング時においても、金型クランプ時などの荷重が第3の半導体チップ29に印加された際にも、NCF12のはみ出し部12eが荷重受けとなるため、第3の半導体チップ29の割れを防ぐことができる。

【0287】その後、個片基板3の裏面3b上に、個片基板3の複数の接続端子3cと電気的に接続する複数の

突起電極である半田ボール11を搭載する。

【0288】すなわち、個片基板3の裏面3bに露出する各バンプランド3d（図14参照）に、半田ボール11をリフローなどによって搭載してCSP31の外部電極を形成する。

【0289】なお、本実施の形態4の製造方法においても、熱圧着ヘッド33の先端（加圧面）の形状を平坦な面にすることができ、前記実施の形態3の一例の熱圧着ヘッド28と比較してその形状を簡単な形状にすることができる。

【0290】以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。

【0291】前記実施の形態1では、金バンプ1dと接続端子3cとの接続信頼性を確保するために、複数の第1の半導体チップ1に対して個別に熱圧着を行うため、作業効率の低下が懸念される。そこで、熱圧着の作業効率の向上を図る対策として、熱圧着時、NCF12などの第1の接着材に施す熱処理の温度を、前記第2の接着材に施す熱処理の温度よりも高くすることで下層側の第1の半導体チップ1の第1の接着材の硬化時間を早め、これによって、熱圧着全体の作業効率の向上を図ることができる。

【0292】ただし、第1の半導体チップ1の熱処理の温度を高くすると、基板とチップの熱膨張係数の差により、熱硬化後の第1の半導体チップ1の反りが大きくなり、第1の半導体チップ1のマウント終了後の第1の半導体チップ1の反りが大きくなる。

【0293】すなわち、第1の半導体チップ1のマウント終了後の第1の半導体チップ1の平坦度は悪化する。このように、第1の半導体チップ1が反っていることが原因で、その上に搭載される第2の半導体チップ2が傾いてしまうと、ワイヤボンディングが良好に行えず、第2の半導体チップ2と接続端子3cとの接続信頼性の低下を招いてしまうことになる。

【0294】そこで、第1の半導体チップ1を熱圧着で搭載した後、第2の半導体チップ2を実施の形態1で説明したダイボンДФィルム材5などの第2の接着材を介して第1の半導体チップ1の裏面1c上に配置し、この第2の半導体チップ2を圧着ヘッドによって保持した状態で、前記第2の接着材に熱処理を施して硬化させ、第2の半導体チップ2を前記第2の接着材を介して第1の半導体チップ1上に固定する。

【0295】その後、圧着ヘッドなどの治具を第2の半導体チップ2から離す。

【0296】このように治具（圧着ヘッド）によって第2の半導体チップ2を保持した状態で第2の半導体チップ2の固定を行うことによって、反った第1の半導体チ

ップ1の上でも平坦度を低下させることなく第2の半導体チップ2を固定することができる。

【0297】また、この時、第2の半導体チップ2の裏面2cには、予めダイボンДФィルム材5が貼り付けられた状態で、チップが個片化されているため、複数のデバイス領域7aに対して個片化されたNCF12を配置する必要がある第1の半導体チップ1の実装工程に比較して、作業効率を上げることができる。

【0298】なお、この方法を用いて、実施の形態2で説明したような複数のデバイス領域7aに対して順次積層のダイボンディングを行う際には、まず、図23に示すように、1つのデバイス領域7aでの第1の半導体チップ1の搭載を前記方法で熱圧着し、その後、第3の半導体チップ26（ここでの第3の半導体チップは、前記実施の形態2で説明したのと同様に、第1の半導体チップ1と同じ構造で、かつ下層側に配置されるものである）を準備した後、第3の半導体チップ26を多数個取り基板7の他のデバイス領域7aに第3の接着材を介して配置する。

【0299】続いて、前記第3の接着材に熱処理を施して硬化させ、第3の半導体チップ26を前記第3の接着材を介して多数個取り基板7の他のデバイス領域7a上に固定する。

【0300】さらに、第2の半導体チップ2を準備し、続いて、第2の半導体チップ2をダイボンДФィルム材5などの第2の接着材を介して前記第1の半導体チップ1上に配置する。

【0301】さらに、第2の半導体チップ2を圧着ヘッドなどの治具によって保持した状態で、前記第2の接着材に熱処理を施して硬化させ、第2の半導体チップ2を前記第2の接着材を介して第1の半導体チップ1上に固定する。

【0302】その後、前記治具を第2の半導体チップ2から離す。

【0303】その後、第4の半導体チップ27（ここでの第4の半導体チップ27は、前記実施の形態2で説明した第2の半導体チップ2と同じ構造で、かつ上層側に配置されるものである）を準備し、続いて、第4の半導体チップ27をダイボンДФィルム材5などの第4の接着材を介して前記第3の半導体チップ26上に配置する。

【0304】さらに、第4の半導体チップ27を圧着ヘッドなどの治具によって保持した状態で、前記第4の接着材に熱処理を施して硬化させ、第4の半導体チップ27を前記第4の接着材を介して第3の半導体チップ26上に固定する。

【0305】その後、前記治具を第4の半導体チップ27から離す。

【0306】また、前記実施の形態2では、第1の接着材として、複数の第1NCF12bを、図17に示すよ

うに、千鳥配列で配置する場合を説明したが、前記第1の接着材の配列は千鳥配列に限られるものではない。例えば、接着材の特性や、熱圧着工程の設定によって熱圧着ヘッド20による隣接するデバイス領域7aへの熱影響が無視できる場合には、隣接する複数のデバイス領域7aに第1の接着材を予め配置するようにしても問題ないが、あまり多数のデバイス領域7aに第1の接着材を配置すると、ダイボンDstage21からの熱に長時間さらされることによって、NCF12が熱硬化してしまう場合がある。このような場合には、図33の変形例に示すように、例えば、1列ごとに第1NCF12bの配置を行い、この1列(3つ)の第1NCF12b上への第1の半導体チップ1の搭載を済ませた後、隣の列に移動して1列ずつ順次、第1NCF12bと第1の半導体チップ1の搭載を行うようにしてもよい。

【0307】また、前記実施の形態1、2では、半導体装置が、2つの半導体チップを積層したスタック構造のものを説明したが、半導体チップの積層数は、図34の変形例に示すように3層またはそれ以上であってもよい。

【0308】このように、3層以上半導体チップを積層する場合でも、フェースダウン実装する半導体チップよりフェースアップ実装する半導体チップの厚さを薄くし、かつフェースダウン実装工程の加圧力を大きくすることによって、接続信頼性を低下させずに、また、チップ割れの発生を防ぎつつCSP25の薄形化を実現することができる。

【0309】なお、図34に示す3層のスタック構造のCSP25では、3段めの半導体チップ24に対して行われるワイヤボンディングは、基板側を1stボンディングとし、チップ側を2ndボンディングとしており、これによって、樹脂封止体6の高さを低く抑えてCSP25の高さが高くないようにしている。

【0310】また、前記実施の形態1では、スタック構造において、下層側の第1の半導体チップ1をロジックチップとし、上層側の第2の半導体チップ2をメモリチップとする場合を説明したが、下層側および上層側の半導体チップの機能については、特に限定されるものではない。

【0311】また、前記実施の形態2では、半導体装置の組み立てとして、多数個取り基板7を用い、かつ一括モールド方式を採用する場合を説明したが、予め、個々に分割された個片基板3を用いて組み立ててもよく、さらに、多数個取り基板7を用いて、かつ1つのデバイス領域7aに1つのキャビティ13aが対応した単数モールド方式で組み立ててもよい。

【0312】また、前記実施の形態1、2では、接着材として、下層側のフリップチップ接続がNCF12やACFなどのフィルム状のものをを用いて行われ、上層側のダイボンDstage21がダイボンDstage21を用いて行われる

場合について説明したが、前記接着材は、ペースト状のものなどであってもよい。

【0313】また、前記実施の形態1、2では、半導体装置がCSP9、22、25の場合について説明したが、前記半導体装置は、スタック構造で、かつ積層された半導体チップが配線基板に搭載され、さらに、最下層の半導体チップよりその上層の半導体チップの厚さが薄ければ、例えば、BGA(Ball Grid Array)やLGA(Land Grid Array)などの他の半導体装置であってもよい。

【0314】

【発明の効果】本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0315】スタック構造の半導体装置において、下層側の半導体チップより上層側の半導体チップの厚さを薄くすることにより、半導体装置の薄形化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1の半導体装置(スタック構造のCSP)の構造の一例を示す断面図である。

【図2】図1に示すCSPの構造を示す部分断面図である。

【図3】図1に示すCSPの組み立てにおけるウェハへのダイボンDstage21貼り付け状態の一例を示す部分断面図である。

【図4】図1に示すCSPの組み立てにおけるウェハダイシングの一例を示す部分断面図である。

【図5】(a)、(b)は図1に示すCSPの組み立ての一例を示す部分断面図であり、(a)は第1チップマウントを示す図、(b)は第1チップ熱圧着を示す図である。

【図6】(a)、(b)は図1に示すCSPの組み立ての一例を示す部分断面図であり、(a)は第2チップマウントを示す図、(b)は第2チップワイヤボンディングを示す図である。

【図7】本発明の実施の形態2の半導体装置(スタック構造のCSP)の構造の一例を示す部分断面図である。

【図8】図7に示すCSPの組み立てにおけるワイヤリング状態の一例を示す拡大平面図である。

【図9】(a)、(b)は図7に示すCSPの組み立ての一例を示す部分断面図であり、(a)は第1チップマウントを示す図、(b)は第1チップ熱圧着を示す図である。

【図10】(a)、(b)は図7に示すCSPの組み立ての一例を示す部分断面図であり、(a)は第2チップマウントを示す図、(b)は第2チップワイヤボンディングを示す図である。

【図11】本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立て手順における全工程の一例を示す製造プロセスフロー

図である。

【図12】本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立て手順における詳細工程の一例を示す製造プロセスフロー図である。

【図13】本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立てにおける多数個取り基板の構造の一例を示す平面図である。

【図14】(a)、(b)は図13に示す多数個取り基板の一部を拡大して示す拡大部分図であり、(a)は図13のA部の詳細を示す平面図であり、(b)は(a)の裏面側の底面図である。

【図15】(a)、(b)は本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立てに用いられる第1および第2の半導体チップの平面図であり、(a)は第1の半導体チップの図、(b)は第2の半導体チップの図である。

【図16】(a)、(b)は図15に示す第1の半導体チップの構造の一例を示す図であり、(a)は拡大部分側面図、(b)は拡大部分平面図である。

【図17】本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立てにおける第1のNCF貼り付け工程の一例を示す平面図である。

【図18】(a)、(b)は図17に示す第1のNCF貼り付け工程の詳細を示す平面図であり、(a)はNCF配置前の図、(b)はNCF貼り付け後の図である。

【図19】(a)、(b)は図17に示す第1のNCF貼り付けに対する第1の半導体チップの配置状態を示す図であり、(a)は第1の半導体チップ配置状態の図、(b)はコレットによる押圧状態を示す図である。

【図20】(a)、(b)は第1の半導体チップのダイボンディング方法の一例を示す図であり、(a)は第1の半導体チップマウント状態の図、(b)は第1の半導体チップ熱圧着後の図である。

【図21】図17に示す第1のNCF貼り付けに対する第1の半導体チップのダイボンディング後の構造の一例を示す平面図である。

【図22】図17に示す第1のNCF貼り付けに対する第2のNCF貼り付け後の構造の一例を示す平面図である。

【図23】(a)、(b)は図22に示す第2のNCF貼り付けに対する第1と第3の半導体チップの実装完了構造を示す図であり、(a)は平面図であり、(b)は(a)のB部の詳細を示す拡大部分平面図である。

【図24】図22に示す第2のNCF貼り付けに対する第2と第4の半導体チップのダイボンディング後の構造の一例を示す平面図である。

【図25】(a)、(b)は第2と第4の半導体チップのワイヤボンディング後の構造を示す図であり、(a)は平面図であり、(b)は(a)のC部の詳細を示す拡大部分平面図である。

【図26】(a)、(b)は第2の半導体チップのワイ

ヤボンディング状態の一例を示す平面図であり、(a)はワイヤボンディング前の図、(b)はワイヤボンディング後の図である。

【図27】(a)、(b)は一括モールドが行われる多数個取り基板の構造の一例を示す平面図であり、(a)は一括モールド前の図、(b)は一括モールド後の図である。

【図28】本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立ての一括モールド方法における樹脂流入方向の一例を示す平面図である。

【図29】(a)、(b)は図28に示す一括モールド方法の一例を示す図であり、(a)は図28のD-D線に沿った断面の一括モールド時の部分断面図、(b)は図28のE-E線に沿った断面の一括モールド時の部分断面図である。

【図30】図28に示す一括モールド方法に対する変形例の一括モールド方法における樹脂流入方向の一例を示す平面図である。

【図31】(a)、(b)は図30に示す変形例の一括モールド方法を示す図であり、(a)は図30のF-F線に沿った断面の一括モールド時の部分断面図、(b)は図30のG-G線に沿った断面の一括モールド時の部分断面図である。

【図32】本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立てにおける一括モールド後の多数個取り基板の構造の一例を示す平面図である。

【図33】本発明の実施の形態2の半導体装置の組み立ての第1のNCF貼り付け工程に対する変形例の第1のNCF貼り付け工程を示す平面図である。

【図34】図1に示すスタック構造のCSPに対する変形例のCSPの構造を示す断面図である。

【図35】本発明の実施の形態3の半導体装置（スタック構造のCSP）の構造の一例を樹脂封止体を透過して示す平面図である。

【図36】図35に示すJ-J線に沿って切断した断面の構造を示す拡大部分断面図である。

【図37】図35に示すCSPに組み込まれる第1の半導体チップの構造の一例を示す平面図である。

【図38】図35に示すCSPの組み立てにおける第1の半導体チップのマウント状態の一例を示す拡大部分断面図である。

【図39】図35に示すCSPの組み立てにおける第1の半導体チップの熱圧着状態の一例を示す拡大部分断面図である。

【図40】図39に示す熱圧着工程における熱圧着後の接着材の形状の一例を示す拡大部分断面図である。

【図41】図35に示すCSPの組み立てにおける第2および第3の半導体チップのマウント状態の一例を示す拡大部分断面図である。

【図42】図35に示すCSPの組み立てにおけるワイ

ヤボンディング状態の一例を示す拡大断面図である。

【図43】図35に示すCSPの変形例の組み立てにおける第1の半導体チップと第2の半導体チップの接着方法の一例を示す拡大断面図である。

【図44】図35に示すCSPの変形例の組み立てにおける第1の半導体チップへの突起電極の形成方法の一例を示す拡大断面図である。

【図45】図35に示すCSPの変形例の組み立てにおける第1の半導体チップの配線基板への接着方法の一例を示す拡大断面図である。

【図46】図35に示すCSPの変形例の組み立てにおける第1および第2の半導体チップの熱圧着状態の一例を示す拡大断面図である。

【図47】図35に示すCSPの変形例の組み立てにおける第3の半導体チップの熱圧着状態の一例を示す拡大断面図である。

【図48】本発明の実施の形態4の半導体装置（スタック構造のCSP）の構造の一例を樹脂封止体を透過して示す平面図である。

【図49】図48に示すCSPに組み込まれる第1の半導体チップの構造の一例を示す平面図である。

【図50】図48に示すCSPの組み立てにおける第1の半導体チップのマウント状態の一例をK-K線に沿って切断した箇所を示す拡大断面図である。

【図51】図48に示すCSPの組み立てにおける第2の半導体チップのマウント状態の一例を示す拡大断面図である。

【図52】図48に示すCSPの組み立てにおける第3の半導体チップのマウント状態の一例を示す拡大断面図である。

【図53】図48に示すCSPの組み立てにおけるワイヤボンディング状態の一例を示す拡大断面図である。

【図54】図48に示すCSPのK-K線に沿って切断した断面の構造を示す拡大断面図である。

【符号の説明】

1 第1の半導体チップ

1 a パッド（電極）

1 b 主面

1 c 裏面

1 d 金バンプ（突起電極）

2 第2の半導体チップ

2 a パッド（電極）

2 b 主面

2 c 裏面

3 個片基板（配線基板）

3 a チップ支持面（主面）

3 b 裏面（反対側の面）

3 c 接続端子（電極）

3 d バンプランド

3 e 第1接続端子（第1の電極）

3 f 第2接続端子（第2の電極）

4 ワイヤ

5 ダイボンドフィルム材（接着材）

6 樹脂封止体

7 多数個取り基板（配線基板）

7 a デバイス領域

7 b ダイシングライン

7 c 金メッキ部

8 一括モールド部

8 a 樹脂ゲート部

9 CSP（半導体装置）

10 ダイシングブレード

11 半田ボール（外部電極）

12 NCF（接着材）

12 a 平坦部

12 b 第1NCF（第1の接着材）

12 c 第2NCF（第2の接着材）

20 12 d 第1チップ接合部（第1の部分）

12 e はみ出し部（第2の部分）

12 f はみ出し部（第3の部分）

13 モールド金型（金型）

13 a キャビティ

13 b 第1の側面

13 c 第2の側面

13 d 第3の側面

13 e 第4の側面

13 f 樹脂注入口

13 g 空気孔

13 h 上型

13 i 下型

13 j 上面

13 k 下面

14 ローラ

15 保護シート

16 ダイシングテープ

17 半導体ウェハ

17 a 主面

40 17 b 裏面

18 ステージ

19 固定リング

20 熱圧着ヘッド

21 ダイボンドステージ

22 CSP（半導体装置）

23 レジンの流れ

24 3段めの半導体チップ

25 CSP（半導体装置）

26 第3の半導体チップ

50 27 第4の半導体チップ

28 熱圧着ヘッド(熱圧着用治具)

28a 突起部

29 第3の半導体チップ

29a パッド(電極)

29b 主面

29c 裏面

30 CSP(半導体装置)

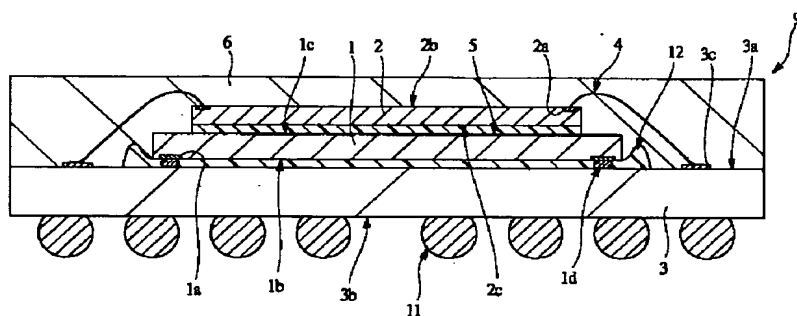
31 CSP(半導体装置)

32 キャピラリ

33 熱圧着ヘッド(熱圧着用治具)

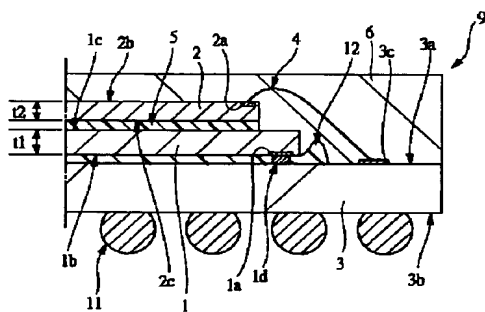
【図1】

図 1



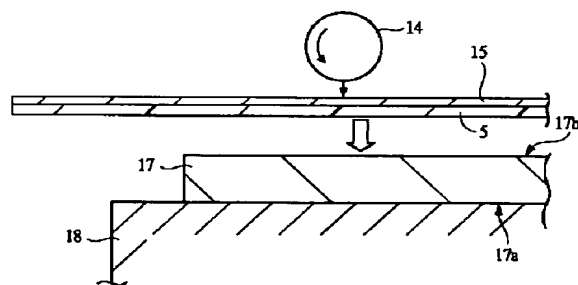
【図2】

図 2



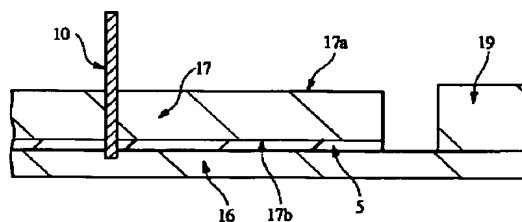
【図3】

図 3



【図4】

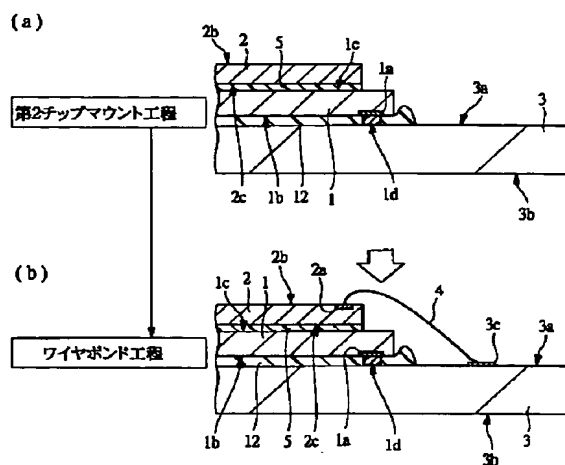
図 4



- | | |
|----------------|--------------------|
| 1: 第1の半導体チップ | 3: 銅片基板(配線基板) |
| 1a: パッド(電極) | 3a: チップ支持面(主面) |
| 1b: 主面 | 3b: 裏面(反対側の面) |
| 1c: 裏面 | 3c: 接続端子(電極) |
| 1d: 金バンプ(突起電極) | 4: ワイヤ |
| 2: 第2の半導体チップ | 5: ダイボンドフィルム材(接着材) |
| 2a: パッド(電極) | 6: 樹脂封止体 |
| 2b: 主面 | 9: CSP(半導体装置) |
| 2c: 裏面 | 11: 半田ボール(外部電極) |
| | 12: NCR(接着材) |

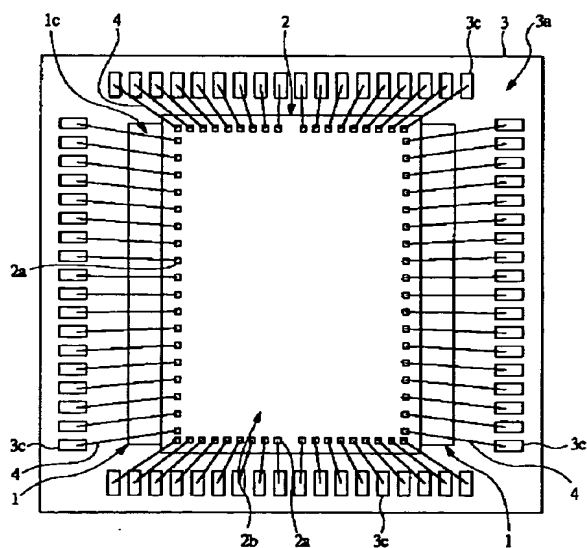
【図 6】

6



【図8】

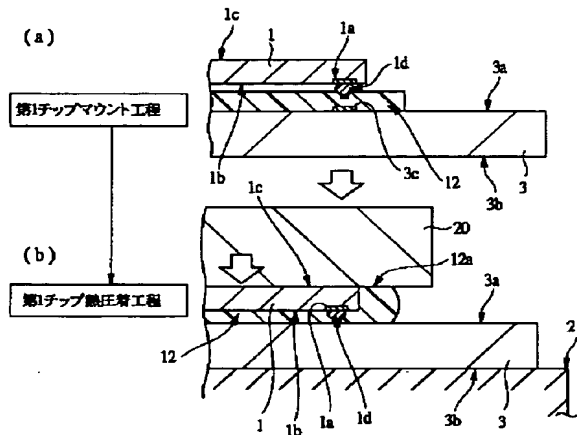
8



22: CSP(半导体装置)

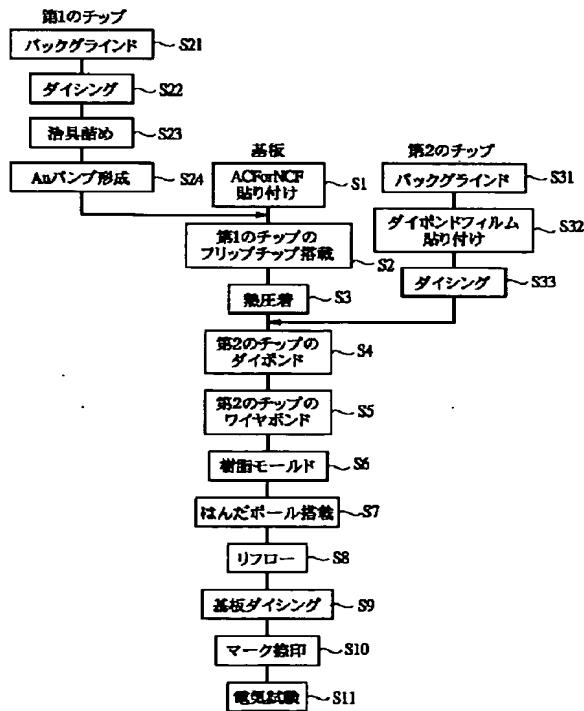
【図9】

図 9



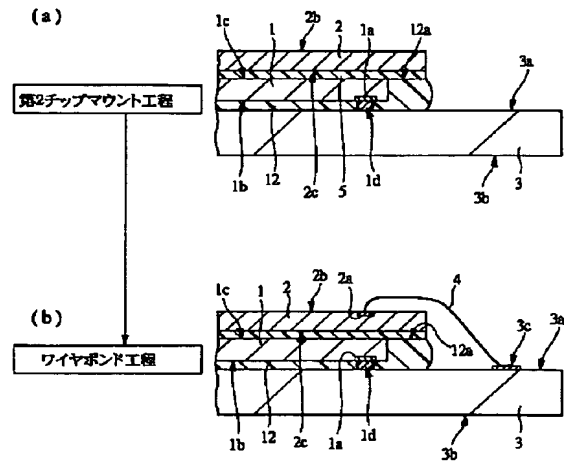
【図11】

図 11



【図10】

図 10



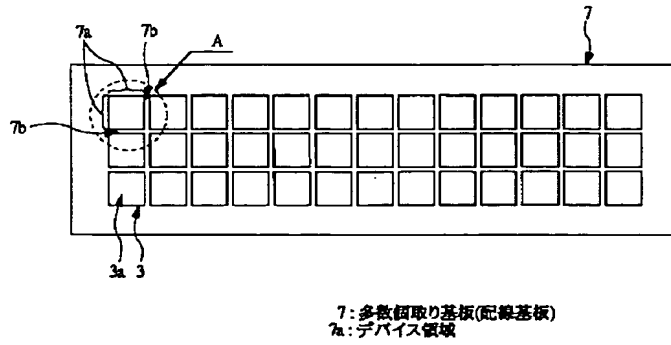
【図12】

図 12

工程フロー		工 程	
		No.	工程名
1	1	1	1stチップ
2	2	2	バックグラインド
3	3	3	ダイシング、治具詰め
4	4	4	バンプ用Au線
5	5	5	バンプボンディング
6	6	6	外観検査
7	7	7	基板
8	8	8	基板バーク
9	9	9	チップマウント樹脂フィルム
10	10	10	チップマウント樹脂フィルム貼り
11	11	11	チップマウント、圧着
12	12	12	2ndチップ
13	13	13	バックグラインド
14	14	14	ダイボンド樹脂フィルム
15	15	15	ダイボンド樹脂フィルム貼り
16	16	16	ダイシング
17	17	17	ダイボンド
18	18	18	Au線
19	19	19	ワイヤボンド
20	20	20	外観検査
21	21	21	封止樹脂
22	22	22	モールド
23	23	23	はんだボール
24	24	24	ボール搭載、リフロー
25	25	25	洗浄
26	26	26	外観検査
27	27	27	基板ダイシング
28	28	28	マーク
29	29	29	電気試験
30	30	30	外観検査
31	31	31	梱包

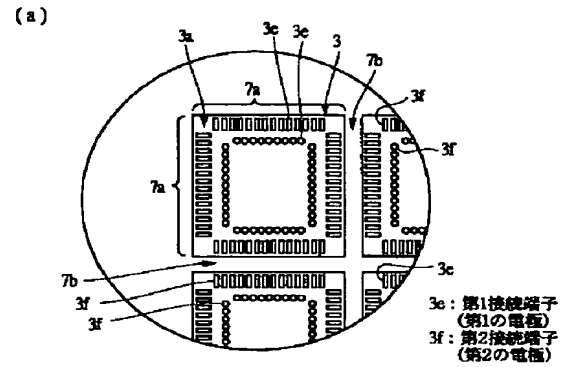
【図13】

図 13



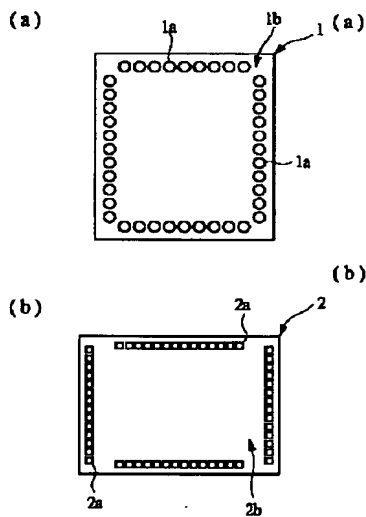
【図14】

図 14



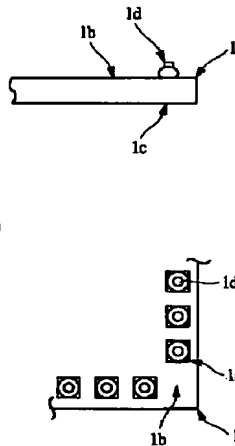
【図15】

図 15



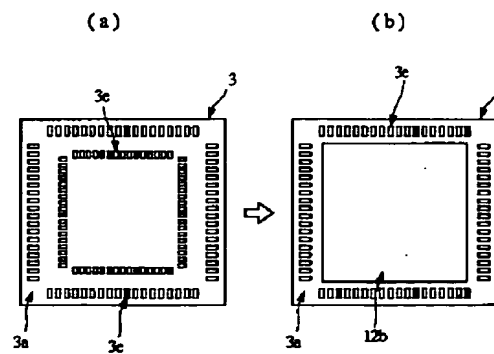
【図16】

図 16



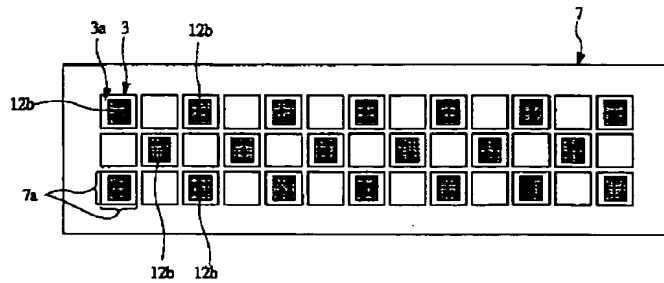
【図18】

図 18



【図17】

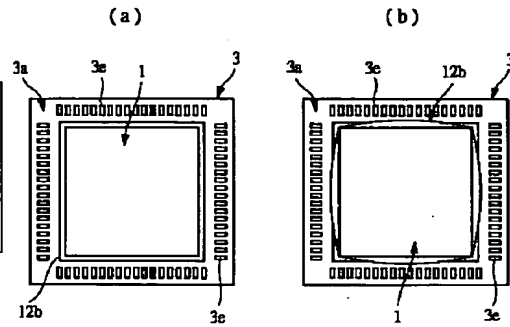
図 17



12b: 第1NCR(第1の接着材)

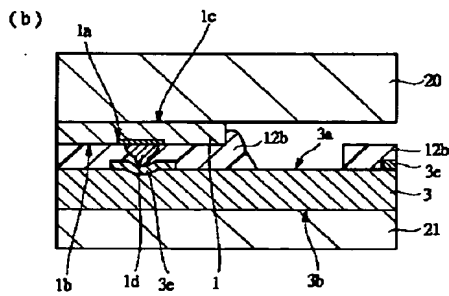
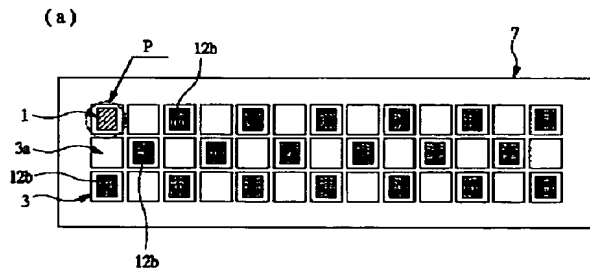
【図20】

図 20



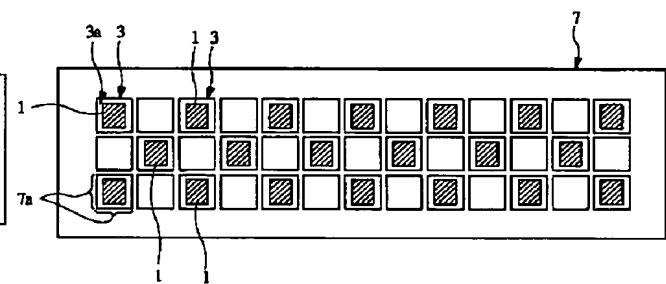
【図19】

図 19



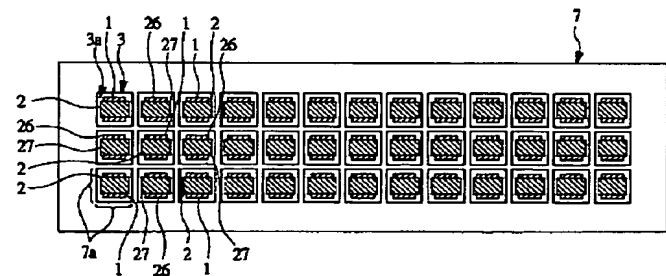
【図21】

図 21



【図24】

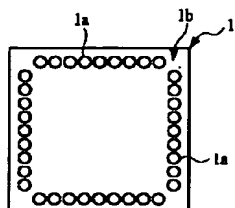
図 24



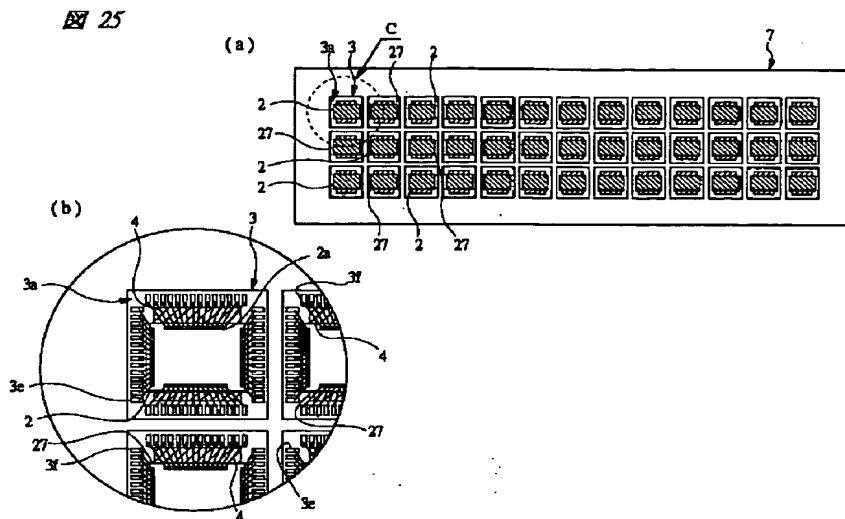
27: 第4の半導体チップ

【図37】

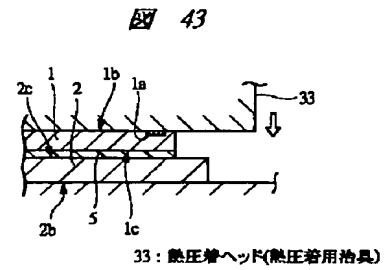
図 37



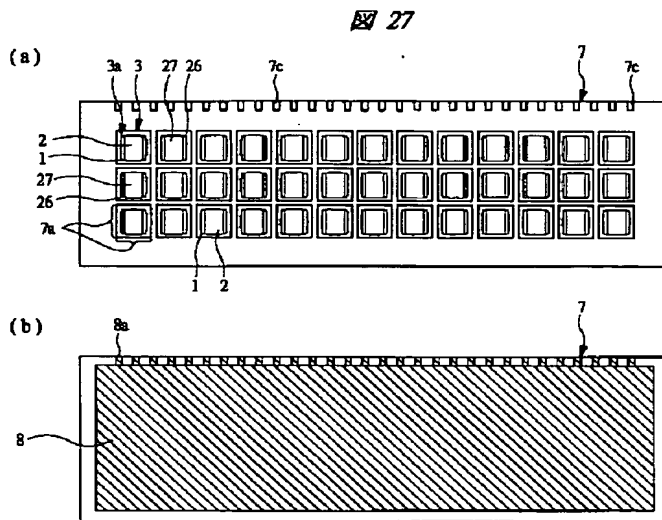
【図25】



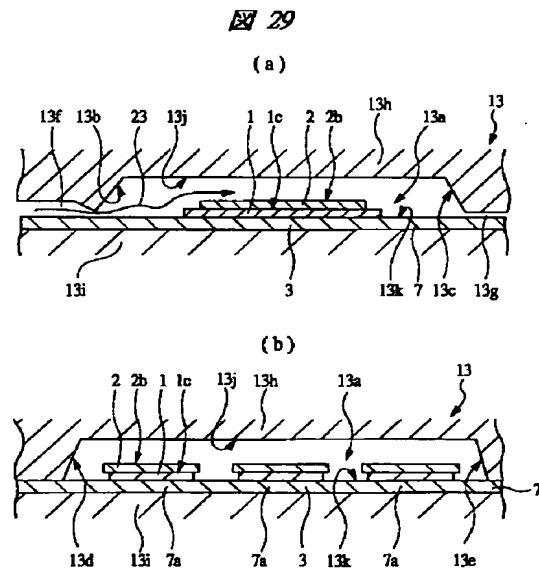
【図43】



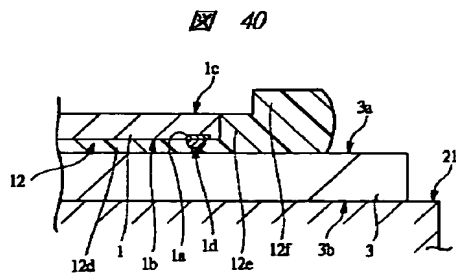
【図27】



【図29】

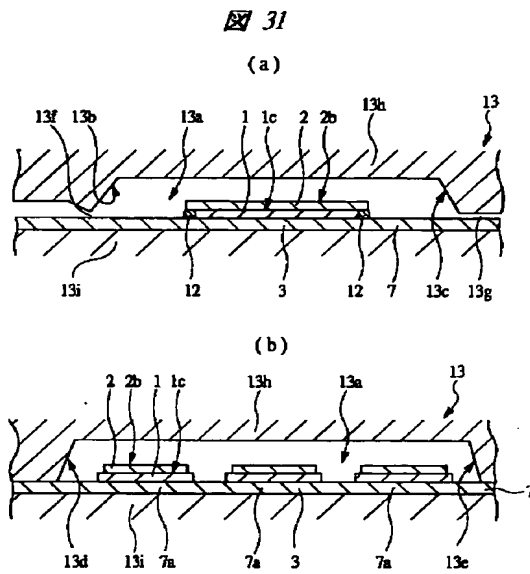


【図40】

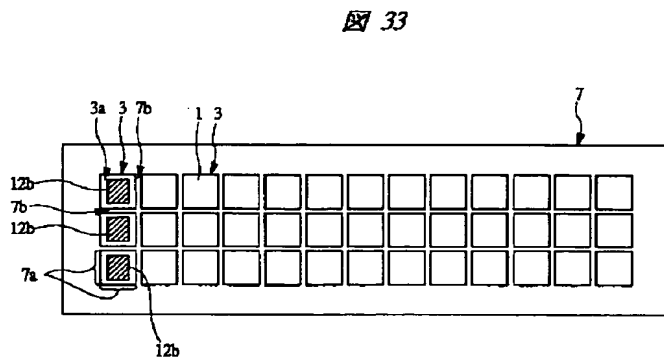


13: モールド金型(金型) 13g: 空気孔
 13a: キャビティ 13h: 上型
 13b: 第1の側面 13i: 下型
 13c: 第2の側面 13j: 上面
 13d: 第3の側面 13k: 下面
 13e: 第4の側面
 13f: 樹脂注入口

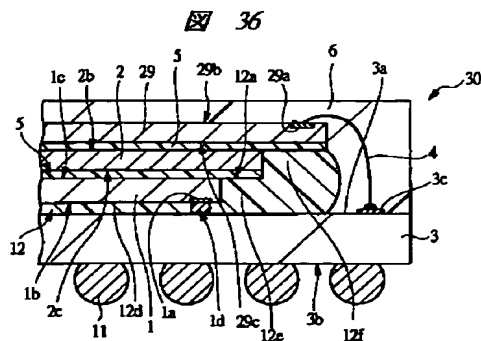
【図 3 1】



【図 3 3】



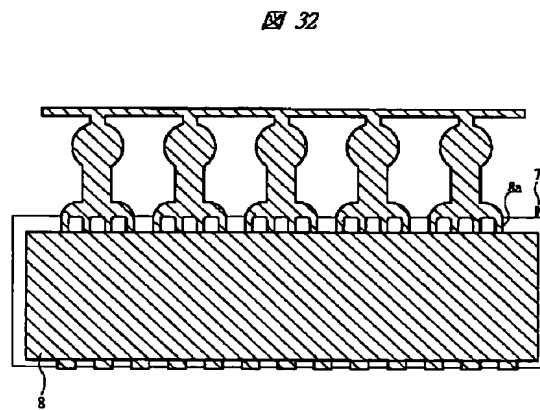
【図 3 6】



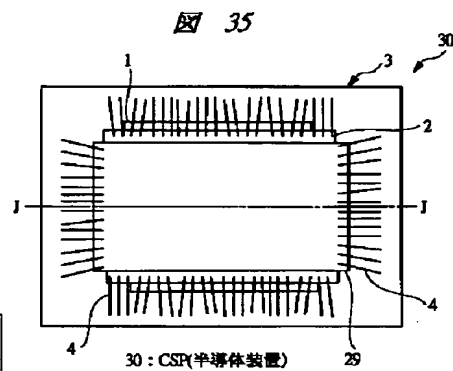
29: 第3の半導体チップ
29a: パッド(電極)
29b: 主面
29c: 裏面(反対側の面)

12d: 第1チップ接合部(第1の部分)
12e: はみ出し部(第2の部分)
12f: はみ出し部(第3の部分)

【図 3 2】

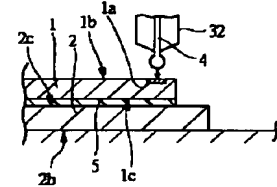


【図 3 5】



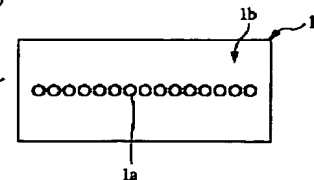
【図 4 4】

44

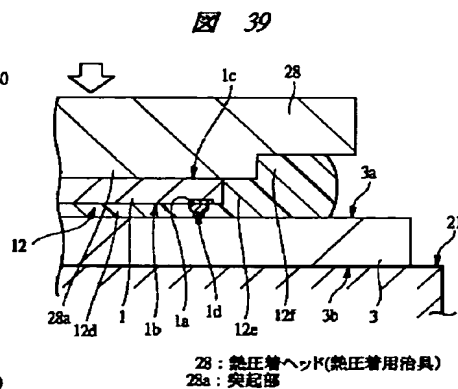


【图 4 9】

49

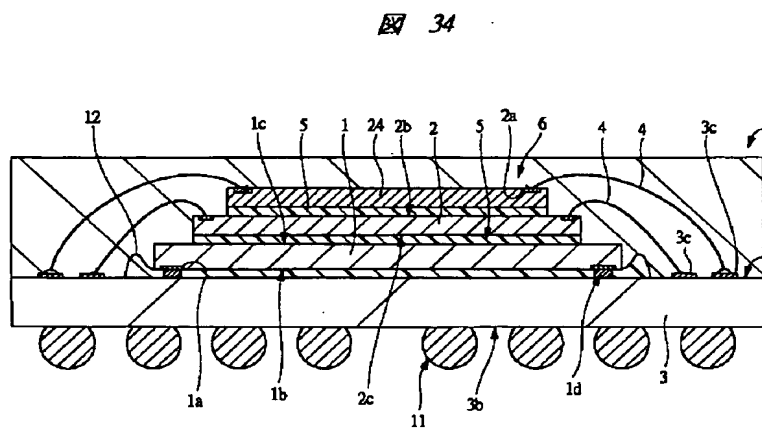


【図 39】



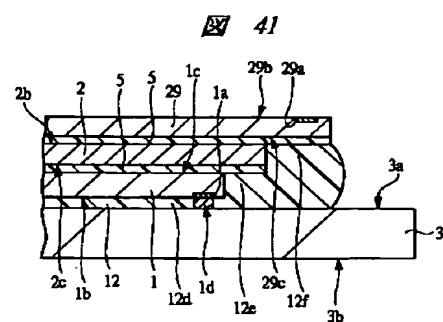
28: 熱圧着ヘッド(熱圧着用治具)
28a: 突起部

【图 3 4】

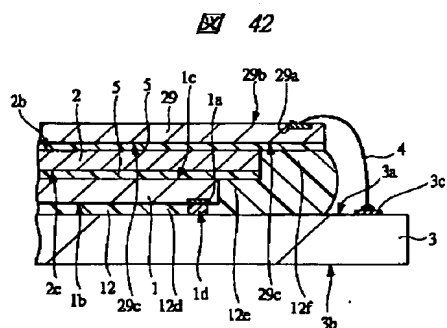


25: CSP(半導体装置)

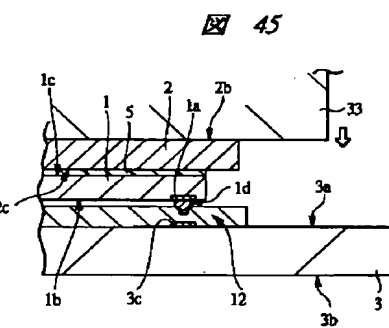
【図 4 1】



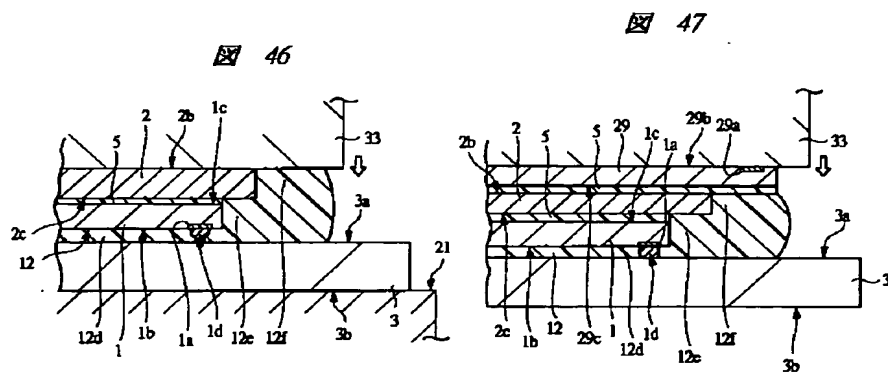
【図 4 2】



【図 4 5】

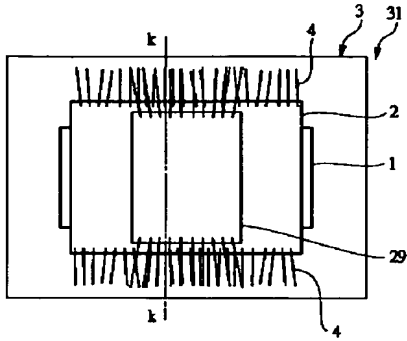


【图 4 7】



【図48】

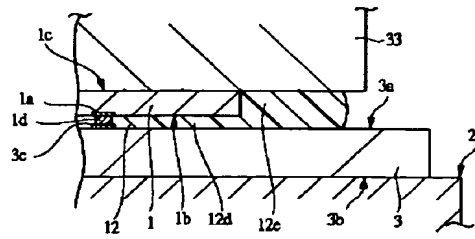
図 48



31: CSP(半導体装置)

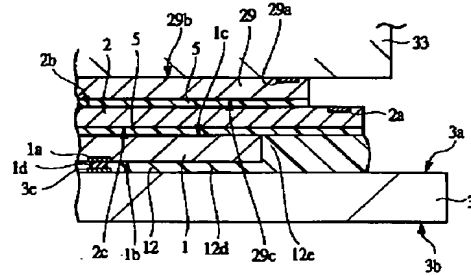
【図50】

図 50



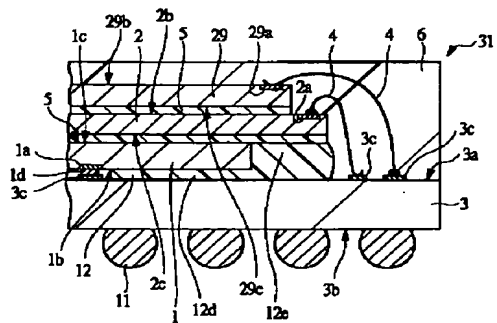
【図52】

図 52



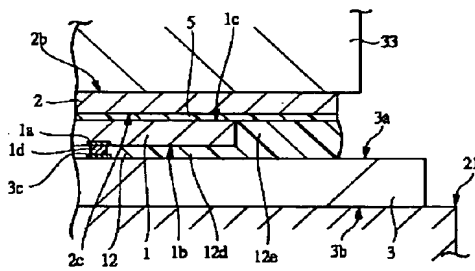
【図54】

図 54



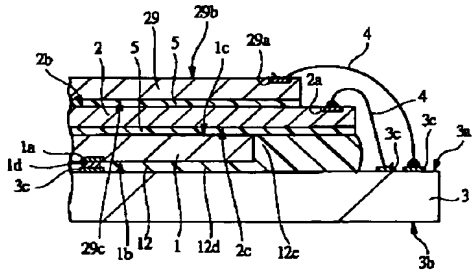
【図51】

図 51



【図53】

図 53



フロントページの続き

(72)発明者 後藤 正克

北海道亀田郡七飯町字中島145番地 日立

北海セミコンダクタ株式会社内